## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-328472

(43) Date of publication of application: 15.11.2002

(51)Int.Cl.

G03F 7/037 CO8G 73/10 G03F G03F 7/022 H01L 21/027 H01L 21/312

(21)Application number: 2002-041308

19.02.2002

(71)Applicant: TORAY IND INC

(72)Inventor: SUWA MITSUFUMI MIYOSHI KAZUTO

**TOMIKAWA MASAO** 

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number : 2001049951

Priority date: 26.02.2001

Priority country: JP

## (54) POSITIVE PHOTOSENSITIVE RESIN PRECURSOR COMPOSITION, ELECTRONIC PARTS USING THE SAME AND DISPLAY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an alkali developable positive photosensitive resin precursor composition.

SOLUTION: The positive photosensitive resin precursor composition contains (a) a polyamic ester and/or polyamic acid polymer soluble in an aqueous alkali solution, (b1) a phenolic hydroxyl-containing thermally crosslinkable compound containing a methylol group substituted by an organic group R1 and represented by the formula -(CH2-OR1) (where R1 is not H) or (b2) a thermally crosslinkable compound containing a urea-base organic group substituted RIO-CH2-1 by organic groups R1 and represented by formula (2) and (c) an esterified quinonediazido compound.

$$-\left(CH_2-OR^1\right)$$
  $\pi(1)$ 

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

17.02.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-328472 (P2002-328472A)

(43)公開日 平成14年11月15日(2002.11.15)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)		
G 0 3 F 7/037		G03F 7/037	2 H O 2 5		
C 0 8 G 73/10		C 0 8 G 73/10	4 J O 4 3		
G03F 7/004	5 0 1	G03F 7/004	501 5F058		
7/022		7/022			
H01L 21/027		H01L 21/312	21/312 D		
	審査請求	未請求 請求項の数13 OL			
(21)出願番号	特顏2002-41308(P2002-41308)	(71)出顧人 000003159			
4		東レ株式会社			
(22)出顧日	平成14年2月19日(2002.2.19)	東京都中央区	日本橋室町2丁目2番1号		
		(72)発明者 諏訪 充史			
(31)優先権主張番号	特願2001-49951 (P2001-49951)	<b>进賀県大</b> 津市	園山1丁目1番1号 東レ株		
(32)優先日	平成13年 2 月26日 (2001. 2. 26)	式会社滋賀事	業場内		
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 三好 一登			
		滋賀県大津市	園山1丁目1番1号 東レ株		
		式会社滋賀事	業場内		
		(72)発明者 富川 真佐夫			
		滋賀県大津市	園山1丁目1番1号 東レ株		
		式会社滋賀事	秦場内		

## (54) 【発明の名称】 ポジ型感光性樹脂前駆体組成物及びそれを用いた電子部品ならびに表示装置

## (57)【要約】

【課題】アルカリ現像可能なポジ型の感光性樹脂前駆体 組成物を提供する。

【解決手段】 (a) と、(b1) または(b2) と、

- (c)を含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂前 駆体組成物。
- (a) アルカリ水溶液に可溶性のポリアミド酸エステルおよび/またはポリアミド酸ポリマー。
- (b 1)フェノール性水酸基含有熱架橋性化合物であって、一般式(1)で表される有機基 $R^1$ で置換されたメチロール基を含有する化合物(但し、 $R^1$ が水素原子の場合を除く)。

## 【化1】

$$-\left(CH_2-OR^1\right)$$
 (1)

(b2) 熱架橋性化合物であって、一般式 (2) で表される有機基R<sup>1</sup>で置換された尿素系有機基を含有する化合物。

【化2】

$$R^1O-CH_2-N$$
 $N-CH_2-OR^1$ 
(2)

最終頁に続く

(c) エステル化したキノンジアジド化合物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) と、(b1) または(b2) と、

- (c)を含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂前 駆体組成物。
- (a) アルカリ水溶液に可溶性のポリアミド酸エステル および/またはポリアミド酸ポリマー。
- (b1) フェノール性水酸基含有熱架橋性化合物であって、一般式(1) で表される有機基R<sup>1</sup>で置換されたメチロール基を含有する(但し、R<sup>1</sup>が水素原子の場合を除く) 化合物。

【化1】

$$-\left(CH_2-OR^1\right) \tag{1}$$

(b2) 熱架橋性化合物であって、一般式 (2) で表される有機基R<sup>1</sup>で置換された尿素系有機基を含有する化合物。

\* [ $\{\text{L2}\}\]$   $R^{1}O-CH_{2}-N$   $N-CH_{2}-OR^{1}$ (2)

(c) エステル化したキノンジアジド化合物。

【請求項2】 R<sup>1</sup> が、炭素数 1 から 2 0 までのアルキル 10 基、または、R<sup>2</sup> C O 基 (R<sup>2</sup> は炭素数 1 から 2 0 までのアルキル基を示す)である請求項 1 記載のポジ型感光性 樹脂前駆体組成物。

【請求項3】(a)成分のポリマーが、一般式(3)で表される構造単位を主成分とする請求項1記載のポジ型感光性樹脂前駆体組成物。

\* [
$$\{L3\}$$
]

(OH)<sub>P</sub>
(OH)<sub>q</sub>
(COOR<sup>5</sup>)<sub>m</sub>

(COOR<sup>5</sup>)<sub>m</sub>

(COOR<sup>5</sup>)

(式中、R<sup>3</sup>は、少なくとも2個以上の炭素原子を有する2価から8価の有機基、R<sup>4</sup>は、少なくとも2個以上の炭素原子を有する2価から6価の有機基、R<sup>5</sup>は水素、または炭素数1から20までの有機基を示す。nは10から100000までの整数、mは0から2までの整数、p、qは0から4までの整数を示す。ただしp+ ※

※q>0である。)

【請求項4】一般式(3)のR³(COOR⁵)m(OH)pが、一般式(4)で表されることを特徴とする請求項3記載のポジ型感光性樹脂前駆体組成物。

【化4】

$$\begin{array}{c|c} R^{6} & \text{CONH} & R^{7} & \text{NHCO} & R^{8} & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & \\$$

 $(R^6, R^8$ は炭素数  $2\sim 20$  より選ばれる 2 価~ 4 価の有機基を示し、 $R^7$  は、炭素数  $3\sim 20$  より選ばれる水酸基を有した 3 価~ 6 価の有機基を示し、 $R^9$ 、 $R^{10}$  は水素、炭素数  $1\sim 20$  までの有機基を示す。 0、 s は 0 から 2 までの整数、r は  $1\sim 4$  までの整数を示す。 0

★【請求項5】一般式(3)のR⁴(OH) qが、一般式 (5)で表されることを特徴とする請求項3記載のポジ 型感光性樹脂前駆体組成物。

【化5】

$$-R^{11}$$
 - NHCO -  $R^{12}$  - CONH -  $R^{13}$  - (5)

 $(R^{11}, R^{13}$ は炭素数  $2 \sim 20$  より選ばれる水酸基を有した 3 価 $\sim 4$  価の有機基を示し、 $R^{12}$  は炭素数  $2 \sim 30$  より選ばれる 2 価の有機基を示す。 t 、 u は 1 あるいは 2 の整数を示す。)

☆【請求項6】一般式(3)のR⁴(OH) qが、一般式 (6)で表されることを特徴とする請求項3記載のポジ 型感光性樹脂前駆体組成物。

(R<sup>14</sup>、R<sup>16</sup>は炭素数2~20までの2価の有機基を示 50 し、R<sup>15</sup>は、炭素数3~20より選ばれる水酸基を有し

た 3 価~ 6 価の有機基を示す。 v は 1 ~ 4 までの整数を示す。)

【請求項7】一般式(3)のR4(OH)qが、一般式(7)で表されることを特徴とする請求項3記載のポジ型感光性樹脂前駆体組成物。

【化7】

 $(R^{17}$ は炭素数  $2\sim20$ より選ばれる 2 価の有機基を示し、 $R^{18}$ は、炭素数  $3\sim20$ より選ばれる水酸基を有した 3 価 $\sim6$  価の有機基を示す。wは  $1\sim4$  までの整数を示す。)

【請求項8】請求項1~7いずれか記載のポジ型感光性 樹脂前駆体組成物を支持基板上に塗布し乾燥する工程、 露光する工程、アルカリ現像液を用いて現像する工程お よび加熱処理する工程を含むレリーフパターンの製造 法。

【請求項9】請求項8記載の製造法により得られるレリーフパターンを表面保護膜または層間絶縁膜として有してなる半導体用電子部品。

【請求項10】基板上に形成された第一電極と、第一電極を部分的に露出せしめるように第一電極上に形成された絶縁層と、第一電極に対向して設けられた第二電極とを含む表示装置であって、前記絶縁層が請求項8記載の製造法により得られるレリーフパターンからなることを特徴とする有機電界発光素子用表示装置。

【請求項11】前記絶縁層が第一電極のエッジ部分を**覆** 30 うように形成されることを特徴とする請求項10記載の表示装置。

【請求項12】絶縁層が第一電極を露出せしめる境界部分における前記絶縁層の断面が順テーパー形状であることを特徴とする請求項10記載の表示装置。

【請求項13】表示装置が、基板上に形成された第一電極と、第一電極上に形成された少なくとも有機化合物からなる発光層を含む薄膜層と、薄膜層上に形成された第二電極とを含む有機電界発光素子からなる表示装置であることを特徴とする請求項10記載の表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体素子の表面 保護膜、層間絶縁膜、有機電界発光素子の絶縁層などに 適した、紫外線で露光した部分がアルカリ水溶液に溶解 するポジ型の感光性ポリイミド前駆体組成物及びそれを 用いた電子部品、表示装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】露光した部分がアルカリ現像により溶解 するポジ型の耐熱性樹脂前駆体組成物としては、ポリア ミド酸にナフトキノンジアジドを添加したもの(特開昭52-13315号公報)、水酸基を有した可溶性ポリイミドにナフトキノンジアジドを添加したもの(特開昭64-60630号公報)、水酸基を有したポリアミドにナフトキノンジアジドを添加したもの(特開昭56-27140号公報)などが知られていた。

【0003】通常のポリアミド酸にナフトキノンジアジドを添加したものではナフトキノンジアジドのアルカリに対する溶解阻害効果よりポリアミド酸のカルボキシル 基の溶解性が高いために、ほとんどの場合希望するパターンを得ることが出来ないという問題点があった。 そこで、ポリアミド酸のアルカリ溶解性のコントロールにするために、ポリアミド酸のカルボキシル基を、エステル基で保護したポリアミド酸誘導体が開発された。しかしながら、このポリアミド酸誘導体にナフトキノンジアジドを添加したものでは、ナフトキノンジアジドのアルカリに対する溶解阻害効果が非常に大きくなり、ほとんどの場合、希望するパターンを得ることはできるが、非常に大きな感度低下を招くという問題点があった。

20 [0004]

【発明が解決しようとする課題】これに対して、このポリアミド酸誘導体にナフトキノンジアジドを添加したものに、種々のフェノール性水酸基を有する化合物を添加することが検討されたが、この場合感度上昇は容易に達成されるが、ポリイミド膜を形成するキュアの過程において、該化合物が飛散してしまい、キュア後の収縮率を大きくするなどの弊害があり、この両特性を両立するには問題があった。

[0005]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、

- (a) と、(b1) または(b2) と、(c) を含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂前駆体組成物。
- (a) アルカリ水溶液に可溶性のポリアミド酸エステル および/またはポリアミド酸ポリマー。
- (b1) フェノール性水酸基含有熱架橋性化合物であって、一般式(1) で表される有機基R<sup>1</sup>で置換されたメチロール基を含有する化合物(但し、R<sup>1</sup>が水素原子の場合を除く)。

[0006]

40 【化8】

$$-\left(CH_2-OR^1\right) \tag{1}$$

【0007】(b2) 熱架橋性化合物であって、一般式(2) で表される有機基R<sup>1</sup>で置換された尿素系有機基を含有する化合物。

[0008]

【化9】

50

【0009】(c)エステル化したキノンジアジド化合 物。

#### [0010]

【発明の実施の形態】本発明は感度向上とキュア後の熱 収縮を抑えるという両方の特性を両立するために、ポリ イミド前駆体及びナフトキノンジアジド化合物に、特定 の有機基を含有する熱架橋性化合物を添加することに特 徴を有し、本発明によって得られた樹脂組成物が、露光 前はアルカリ現像液にほとんど溶解せず、露光すると容 易にアルカリ現像液に溶解するために、現像による膜減\* \*りが少なく、かつ短時間に現像できること、さらに本発 明で用いた熱架橋性化合物で架橋したことによってキュ ア後の収縮率を少なく押さえることができるものであ

【0011】本発明におけるアルカリ水溶液に可溶性の ポリアミド酸エステルおよび/またはポリアミド酸ポリ マー(a)とは、加熱あるいは適当な触媒により、イミ ド環、オキサゾール環、その他の環状構造を有するポリ マーとなり得るものである。環構造となることで、耐熱 10 性、耐溶剤性が飛躍的に向上する。

【0012】本発明で使用されるポリマー(a)として は、一般式(3)および/または下記一般式(8)~ (11)で表される構造単位を主成分とするポリマーで ある。

[0013] 【化10】

$$\begin{array}{c|c}
 & (OH)_{\mathbf{p}} & (OH)_{\mathbf{q}} \\
 & & | \\
 & & | \\
 & (COOR^5)_{\mathbf{m}}
\end{array}$$

【0014】 (式中、R3は、少なくとも2個以上の炭 素原子を有する2価から8価の有機基、R4は、少なく とも2個以上の炭素原子を有する2価から6価の有機 基、R5は水素、または炭素数1から20までの有機基 を示す。nは10から10000までの整数、mは0% ※から2までの整数、p、qは0から4までの整数を示 す。ただしp+q>0である。)

[0015] 【化11】

$$\begin{array}{c} X \hspace{-0.1cm} - (R^{22}) \hspace{-0.1cm} - \hspace{-0.1cm} - (CO - R^{19} - CO - R^{19} - CO$$

$$Y = (R^{22})_{m1}^{-}CO = (NH \cdot R^{20} - NH \cdot R^{20} - (1 1)$$

【0016】式中R<sup>19</sup>は4価の有機基、R<sup>20</sup>は2から4 価の有機基、R21は水素、または炭素数1から20まで の有機基、R<sup>22</sup>は2価の有機基、X, Yは、カルボキシ ル基、フェノール性水酸基、スルホン酸基、チオール基 より選ばれる基を少なくとも一つ有する2から8価の有 機基を示す。 n 1 は 1 0 から 1 0 0 0 0 0 までの整数、 m1は0から10までの整数を示す。

【0017】これらは、ポリマー主鎖内部またはポリマ

のアルカリ可溶性基を有しており、このアルカリ可溶性 基の存在のために、アルカリ水溶液に対する溶解性がア ルカリ可溶性基を有さないポリアミド酸よりも良好にな

【0018】本発明における上記一般式(3)は、ポリ マー主鎖内部にポリアミド酸由来のカルボキシル基以外 のアルカリ可溶性基を有するものに属する。

【0019】アルカリ可溶性基の中でも、特に、フェノ ー主鎖末端に、ポリアミド酸由来のカルボキシル基以外 50 ール性の水酸基がアルカリ水溶液に対する溶解性がより

好ましい。また、一般式(3)は、フッ素原子を、式中 に10重量%以上有することで、アルカリ水溶液で現像 する際に、膜の界面に撥水性が適度に出るために、界面 のしみこみなどが抑えられる。しかしながら、フッ案原 子含有量が20重量%を越えると、アルカリ水溶液に対 する溶解性が低下すること、熱処理により環状構造にし たポリマーの耐有機溶媒性が低下すること、発煙硝酸に 対する溶解性が低下するために好ましくない。このよう に、フッ索原子は10重量%以上20重量%以下含まれ ることが好ましい。

【0020】上記一般式(3)中、R3は酸二無水物の 構造成分を表しており、この酸二無水物は芳香族環を含 有し、かつ、水酸基を1個~4個有した、少なくとも2\* \*個以上の炭素原子を有する2価~8価の有機基であるこ とが好ましく、炭素数6~30の3価または4価の有機 基がさらに好ましい。

【0021】具体的には、一般式(4)に示されるよう な構造のものが好ましく、この場合、R6、R8は得られ るポリマーの耐熱性のため芳香族環を含んだものが好ま しく、その中でも特に好ましい構造としてトリメリット 酸、トリメシン酸、ナフタレントリカルボン酸残基のよ うなものを挙げることができる。またR<sup>7</sup>は炭素数3~ 10 20より選ばれる水酸基を有した3価~6価の有機基が 好ましい。

- 4個有した、少なくとも
$$2*$$
 【 $2$ 】
-  $R^5$  — CONH —  $R^7$  — NHCO —  $R^8$  — (4:  $R^6$  — COOR $R^9$ )  $R^8$  — (4:  $R^8$  — COOR $R^9$ )  $R^8$  — (COOR $R^9$ )  $R^8$  — (COOR $R^9$ )  $R^8$  — (COOR $R^9$ )  $R^9$  — (COOR $R^9$ )  $R^9$ 

【0023】さらに、水酸基はアミド結合と隣り合った 位置にあることが好ましい。このような例として、フッ 素原子を含んだ、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフ 20 ェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス (3-ヒドロキ シー4ーアミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、フ ッ素原子を含まない、ビス (3-アミノ-4-ヒドロキ シフェニル)プロパン、ビス(3-ヒドロキシー4-ア ミノフェニル)プロパン、3,3'ージアミノー4、 4'ージヒドロキシビフェニル、3,3'ージアミノー 4, 4'ージヒドロキシビフェニル、2, 4ージアミノ ーフェノール、2,5~ジアミノフェノール、1,4-ジアミノー2, 5-ジヒドロキシベンゼンのアミノ基が 結合したものなどを挙げることができる。 *※30* 

※【0024】また、R<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>は同じでも異なっていて もよく、水素、あるいは炭素数1~20までの有機基が 良い。炭素数が20より大きくなるとアルカリ現像液に 対する溶解性が低下する。o、sは1または2をあらわ しており、rは1~4までの整数を表している。rが5 以上になると、得られる耐熱性樹脂膜の特性が低下す る。

【0025】一般式 (3) のR<sup>3</sup> (COOR<sup>5</sup>) m (O H) pが一般式(4)で表される化合物の中で、好まし い化合物を例示すると、特にこれらに限定されないが、 下記に示したような構造のものが挙げられる。

[0026]

[0022]

【化13】

【0027】また、アルカリに対する溶解性、感光性 能、耐熱性を損なわない範囲で、水酸基を有していない テトラカルボン酸、ジカルボン酸で変性することもでき る。この例としては、ピロメリット酸、ベンゾフェノン テトラカルボン酸、ビフェニルテトラカルボン酸、ジフ ェニルエーテルテトラカルボン酸、ジフェニルスルホン テトラカルボン酸などの芳香族テトラカルボン酸やその カルボキシル基2個をメチル基やエチル基にしたジェス テル化合物、ブタンテトラカルボン酸、シクロペンタン 50 と、アルカリに対する溶解性、感光性が損なわれる恐れ

テトラカルボン酸などの脂肪族のテトラカルボン酸やそ のカルボキシル基2個をメチル基やエチル基にしたジェ ステル化合物、テレフタル酸、イソフタル酸、ジフェニ ルエーテルジカルボン酸、ナフタレンジカルボン酸など の芳香族ジカルボン酸、アジピン酸などの脂肪族ジカル ボン酸などを挙げることができる。これらは、酸成分の 50モル%以下の変性が好ましいが、さらに好ましくは 30モル%以下である。50モル%以上の変性を行う

がある。

【0028】上記一般式(3)中、R<sup>4</sup>はジアミンの構造成分を表している。この中で、R<sup>4</sup>の好ましい例としては、得られるポリマーの耐熱性のため芳香族を有し、かつ水酸基を有するものが好ましく、具体的な例としてはフッ素原子を有した、ビス(アミノーヒドロキシーフェニル)へキサフルオロプロパン、フッ素原子を有さな\*

\*い、ジアミノジヒドロキシピリミジン、ジアミノジヒドロキシピリジン、ヒドロキシージアミノーピリミジン、ジアミノフェノール、ジヒドロキシベンチジンなどの化合物や一般式(5)、(6)、(7)に示す構造のものをあげることができる。

[0029]

【化14】

$$\begin{array}{c|c} -R^{11} - NHCO - R^{12} - CONH - R^{13} - \\ & & \\ (HO)_{t} & & \\ & & \\ (HO)_{u} & \end{array}$$

【0030】R<sup>11</sup>、R<sup>13</sup>は炭素数2~20より選ばれる 水酸基を有した3価~4価の有機基を示し、R<sup>12</sup>は炭素 数2~30より選ばれる2価の有機基を示す。 t、uは※

※1あるいは2の整数を示す。

[0031]

【化15】

【0032】R<sup>14</sup>、R<sup>16</sup>は炭素数2~20までの2価の 有機基を示し、R<sup>15</sup>は、炭素数3~20より選ばれる水 20 酸基を有した3価~6価の有機基を示す。vは1~4ま での整数を示す。

[0033]

【化16】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 R^{17} & CONH & R^{18} \\
 & (HO)_{w}
\end{array}$$

【0034】R<sup>17</sup>は炭素数2~20より選ばれる2価の *30* 有機基を示し、R<sup>18</sup>は、炭素数3~20より選ばれる水 酸基を有した3価~6価の有機基を示す。wは1~4ま★

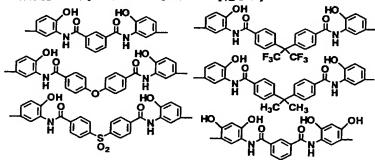
★での整数を示す。

【0035】この中で、一般式 (5) のR<sup>11</sup>、R<sup>13</sup>、一般式 (6) のR<sup>15</sup>、一般式 (7) のR<sup>18</sup>は、得られるポリマーの耐熱性のため芳香族環、および水酸基を有した有機基が好ましい。一般式 (5) のR<sup>12</sup>、一般式 (6) のR<sup>14</sup>、R<sup>16</sup>、一般式 (7) のR<sup>17</sup>は、得られるポリマーの耐熱性のため芳香族環を有した有機基が好ましい。また一般式 (5) のt、uは1あるいは2の整数を示し、一般式 (6) のv、一般式 (7) のwは1~4までの整数を示す。

【0036】一般式(3)のR<sup>4</sup>(OH) qが一般式(5)で表される具体例を下記に示す。

[0037]

【化17】



【0038】また、一般式 (3) のR<sup>4</sup> (OH) qが一般式 (6) で表される具体例を下記に示す。

[0039] [化18]

【0040】一般式 (3) のR4 (OH) gが一般式 (7)で表される具体例を下記に示す。

[0041]

【化19】

【0042】一般式 (5) において、R<sup>11</sup>、R<sup>13</sup>は炭素 数2~20より選ばれる水酸基を有した3価~4価の有 機基を示しており、得られるポリマーの耐熱性のために 芳香族環を有したものが好ましい。具体的にはヒドロキ シフェニル基、ジヒドロキシフェニル基、ヒドロキシナ フチル基、ジヒドロキシナフチル基、ヒドロキシビフェ ニル基、ジヒドロキシビフェニル基、ビス(ヒドロキシ フェニル) ヘキサフルオロプロパン基、ビス (ヒドロキ シフェニル) プロパン基、ビス (ヒドロキシフェニル) スルホン基、ヒドロキシジフェニルエーテル基、ジヒド ロキシジフェニルエーテル基などを表す。また、ヒドロ キシシクロヘキシル基、ジヒドロキシシクロヘキシル基 などの脂肪族の基も使用することができる。R12は炭素 数2~30までの2価の有機基を表している。得られる ポリマーの耐熱性のためには芳香族を有した2価の基が よく、このような例としてはフェニル基、ピフェニル 基、ジフェニルエーテル基、ジフェニルヘキサフルオロ プロパン基、ジフェニルプロパン基、ジフェニルスルホ ン基などをあげることができるが、これ以外にも脂肪族 のシクロヘキシル基なども使用することができる。

【0043】一般式(6)において、R14、R16は炭素 数2~20までの2価の有機基を表している。得られる ポリマーの耐熱性のために芳香族を有した2価の基がよ く、このような例としてはフェニル基、ビフェニル基、 ジフェニルエーテル基、ジフェニルヘキサフルオロプロ パン基、ジフェニルプロパン基、ジフェニルスルホン基 などをあげることができるが、これ以外にも脂肪族のシ クロヘキシル基なども使用することができる。R15は、 炭素数3~20より選ばれる水酸基を有した3価~6価 の有機基を示しており、得られるポリマーの耐熱性のた

めに芳香族環を有したものが好ましい。具体的にはヒロ ドキシフェニル基、ジヒドロキシフェニル基、ヒドロキ シナフチル基、ジヒドロキシナフチル基、ヒドロキシビ フェニル基、ジヒドロキシビフェニル基、ビス(ヒドロ キシフェニル) ヘキサフルオロプロパン基、ビス (ヒド ロキシフェニル) プロパン基、ビス (ヒドロキシフェニ ル)スルホン基、ヒドロキシジフェニルエーテル基、ジ ヒドロキシジフェニルエーテル基などを表す。また、ヒ ドロキシシクロヘキシル基、ジヒドロキシシクロヘキシ ル基などの脂肪族の基も使用することができる。

【0044】一般式(7)においてR17は炭素数2~2 0より選ばれる2価の有機基を表している。得られるポ リマーの耐熱性から芳香族を有した2価の基がよく、こ のような例としてはフェニル基、ビフェニル基、ジフェ ニルエーテル基、ジフェニルヘキサフルオロプロパン 基、ジフェニルプロパン基、ジフェニルスルホン基など をあげることができるが、これ以外にも脂肪族のシクロ ヘキシル基なども使用することができる。R18は炭素数 3~20より選ばれる水酸基を有した3価~6価の有機 基を示しており、得られるポリマーの耐熱性のために芳 香族環を有したものが好ましい。具体的にはヒドロキシ フェニル基、ジヒドロキシフェニル基、ヒドロキシナフ チル基、ジヒドロキシナフチル基、ヒドロキシビフェニ ル基、ジヒドロキシビフェニル基、ビス (ヒドロキシフ ェニル) ヘキサフルオロプロパン基、ビス (ヒドロキシ フェニル) プロパン基、ビス (ヒドロキシフェニル) ス ルホン基、ヒドロキシジフェニルエーテル基、ジヒドロ キシジフェニルエーテル基などを表す。また、ヒドロキ 40 シシクロヘキシル基、ジヒドロキシシクロヘキシル基な どの脂肪族の基も使用することができる。

【0045】また、1~40モル%の範囲の、他のジア ミン成分を用いて変性することもできる。これらの例と しては、フェニレンジアミン、ジアミノジフェニルエー テル、アミノフェノキシベンゼン、ジアミノジフェニル メタン、ジアミノジフェニルスルホン、ビス (トリフル オロメチル) ベンチジン、ビス (アミノフェノキシフェ ニル) プロパン、ビス (アミノフェノキシフェニル) ス ルホンあるいはこれらの芳香族環にアルキル基やハロゲ ン原子で置換した化合物などを挙げることができる。こ

30

のような例として、フェニレンジアミン、ジアミノジフ ェニルエーテル、アミノフェノキシベンゼン、ジアミノ ジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン、ビス (トリフルオロメチル) ベンチジン、ビス (アミノフェ ノキシフェニル)プロパン、ビス(アミノフェノキシフ エニル)スルホンあるいはこれらの芳香族環にアルキル 基やハロゲン原子で置換した化合物など、脂肪族のシク ロヘキシルジアミン、メチレンビスシクロヘキシルアミ ンなどが挙げられる。このようなジアミン成分を40モ ル%より多く共重合すると得られるポリマーの耐熱性が 10 低下する。

【0046】一般式(3)のR5は水素、または炭素数 1~20の有機基を表している。得られるポジ型感光性 樹脂前駆体溶液の安定性からは、R5は有機基が好まし いが、アルカリ水溶液の溶解性より見ると水素が好まし い。本発明においては、水素原子とアルキル基を混在さ せることができる。このR5の水索と有機基の量を制御 することで、アルカリ水溶液に対する溶解速度が変化す るので、この調整により適度な溶解速度を有したポジ型 感光性樹脂前駆体組成物を得ることができる。好ましい 20 範囲は、R5の10%~90%が水素原子であることで ある。 R<sup>5</sup>の炭素数が20を越えるとアルカリ水溶液に 溶解しなくなる。以上よりR<sup>5</sup>は、好ましくは炭素数1 ~16までの炭化水素基を少なくとも1つ以上含有し、 その他は水素原子であることがよい。

【0047】また一般式(3)のmはカルボキシル基の 数を示しており、0~2までの整数を示している。一般 式(3)のnは本発明のポリマーの構造単位の繰り返し 数を示しており、10~100000の範囲であること が好ましい。

【0048】ポリアミド酸と類似の耐熱性高分子前駆体 としてポリヒドロキシアミドをポリアミド酸の代わりに 使用することも出来る。このようなポリヒドロキシアミ ドの製造方法としては、ビスアミノフェノール化合物と ジカルボン酸を縮合反応させることで得ることが出来 る。具体的には、ジシクロヘキシルカルボジイミド(D CC)のような脱水縮合剤と酸を反応させ、ここにビス アミノフェノール化合物を加える方法やピリジンなどの 3級アミンを加えたビスアミノフェノール化合物の溶液 にジカルボン酸ジクロリドの溶液を滴下するなどがあ る。

【0049】ポリヒドロキシアミドを使用する場合、ポ リヒドロキシアミドの溶液にナフトキノンジアジドスル ホン酸エステルのような感光剤を加えることで、紫外線 で露光した部分をアルカリ水溶液で除去できるポジ型の 感光性耐熱性樹脂前駆体組成物を得ることが出来る。

【0050】さらに、基板との接着性を向上させるため に、耐熱性を低下させない範囲で一般式 (3) のR<sup>3</sup>、 R<sup>4</sup>にシロキサン構造を有する脂肪族の基を共重合して

アミノプロピル) テトラメチルジシロキサン、ビス (p ーアミノーフェニル) オクタメチルペンタシロキサンな どを1~10モル%共重合したものなどがあげられる本 発明の(a)成分のうち、ポリマー主鎖内部にアルカリ 可溶性基を有するものは、一般式(3)で表される構造 単位のみからなるものであっても良いし、他の構造単位 との共重合体あるいはブレンド体であっても良い。その 際、一般式(3)で表される構造単位を90モル%以上 含有していることが好ましい。共重合あるいはブレンド

14

に用いられる構造単位の種類および量は最終加熱処理に よって得られるポリイミド系ポリマの耐熱性を損なわな い範囲で選択することが好ましい。 【0051】本発明の上記一般式(3)で表されるポリ

マーは公知の方法により合成される。例えば、低温中で テトラカルボン酸二無水物とジアミン化合物を反応させ る方法、テトラカルボン酸二無水物とアルコールとによ りジエステルを得、その後アミンと縮合剤の存在下で反 応させる方法、テトラカルボン酸二無水物とアルコール とによりジエステルを得、その後残りのジカルボン酸を 酸クロリド化し、アミンと反応させる方法などで合成す ることができる。

【0052】本発明における上記一般式 (8)~(1 1)は、ポリマー主鎖末端にポリアミド酸由来のカルボ キシル基以外のアルカリ可溶性基を有するものに属す

【0053】上記一般式 (8) ~ (11) 中、R<sup>19</sup>は酸 二無水物の構造成分を表しており、この酸二無水物は芳 香族環又は脂肪族環を含有する4価の有機基であり、な かでも炭素原子数5~40の有機基であることが好まし

【0054】酸二無水物としては具体的には、ピロメリ ット酸二無水物、3,3'、4,4'ービフェニルテト ラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'ービフェニ ルテトラカルボン酸二無水物、2, 2', 3, 3'ービ フェニルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4, 4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2. 2', 3, 3'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無 水物、2, 2ービス(3, 4ージカルボキシフェニル) プロパン二無水物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキ シフェニル) プロパン二無水物、1,1-ビス(3,4 ージカルボキシフェニル)エタン二無水物、1,1-ビ ス (2, 3-ジカルボキシフェニル) エタン二無水物、 ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) メタン二無水 物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)メタン二無 水物、ビス (3, 4ージカルボキシフェニル) スルホン 二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エー テル二無水物、1,2,5,6-ナフタレンテトラカル ボン酸二無水物、2,3,6,7-ナフタレンテトラカ ルボン酸二無水物、2,3,5,6-ピリジンテトラカ もよい。具体的には、ジアミン成分として、ビス(3- 50 ルボン酸二無水物、3,4,9,10-ペリレンテトラ

カルボン酸二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボ キシフェニル) ヘキサフルオロプロパン二無水物などの 芳香族テトラカルボン酸二無水物や、ブタンテトラカル ボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロペンタンテト ラカルボン酸二無水物などの脂肪族のテトラカルボン酸 二無水物などを挙げることができる。これらのうち、 3, 3', 4, 4'ーピフェニルテトラカルボン酸二無 水物、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン 酸二無水物、2,2',3,3'-ビフェニルテトラカ ルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4'ーベンゾフェノ 10 ニルスルホン、4, 4'ージアミノジフェニルスルホ ンテトラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'ーベ ンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,2-ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、 2, 2ービス(2, 3ージカルボキシフェニル)プロパ ン二無水物、1,1-ビス(3,4-ジカルボキシフェ ニル) エタン二無水物、1, 1-ビス (2, 3-ジカル ボキシフェニル) エタン二無水物、ビス (3, 4-ジカ ルボキシフェニル) メタン二無水物、ビス (2, 3-ジ カルボキシフェニル) メタン二無水物、ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル) エーテル二無水物、2,2 ービス(3,4ージカルボキシフェニル)へキサフルオ ロプロパン二無水物が好ましい。これらは単独で又は2 種以上を組み合わせて使用される。

【0055】上記一般式 (8) ~ (11) のR<sup>20</sup>は、ジ アミンの構造成分を表しており、このジアミンとして は、芳香族環又は脂肪族環を含有する2~4価の有機基 を表し、中でも炭素原子数5~40の有機基が好まし

【0056】ジアミンの具体的な例としては、3,4' ージアミノジフェニルエーテル、4, 4'ージアミノジ フェニルエーテル、3,4'ージアミノジフェニルメタ ン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、3,4'ー ジアミノジフェニルスルホン、4,4'ージアミノジフ ェニルスルホン、3, 4'ージアミノジフェニルスルヒ ド、4,4'ージアミノジフェニルスルヒド、1,4-ビス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、ベンジン、m -フェニレンジアミン、P-フェニレンジアミン、1, 5ーナフタレンジアミン、2,6ーナフタレンジアミ ン、ピス (4-アミノフェノキシフェニル) スルホン、 ピス (3-アミノフェノキシフェニル) スルホン、ピス (4-アミノフェノキシ) ビフェニル、ビス {4-(4 -アミノフェノキシ) フェニル) エーテル、1, 4-ビ ス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、2, 2'ージメ チルー4, 4'ージアミノビフェニル、2, 2'ージエ チルー4、4'ージアミノビフェニル、3、3'ージメ チルー4, 4'ージアミノビフェニル、3, 3'ージエ チルー4, 4'ージアミノビフェニル、2, 2', 3, 3'ーテトラメチルー4,4'ージアミノビフェニル、 3, 3', 4, 4'ーテトラメチルー4, 4'ージアミ 50

ノビフェニル、2,2'-ジ(トリフルオロメチル)-4, 4'ージアミノビフェニル、あるいはこれらの芳香 族環にアルキル基やハロゲン原子で置換した化合物や、 脂肪族のシクロヘキシルジアミン、メチレンビスシクロ ヘキシルアミンなどが挙げられる。

16

【0057】これらのうち、3、4'ージアミノジフェ ニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルエーテ ル、3,4'ージアミノジフェニルメタン、4,4'ー ジアミノジフェニルメタン、3,4'ージアミノジフェ ン、3、4'ージアミノジフェニルスルヒド、4、4' ージアミノジフェニルスルヒド、mーフェニレンジアミ ン、P-フェニレンジアミン、1, 4-ビス (4-アミ ノフェノキシ) ベンゼン等が好ましい。特に好ましくは 3, 4'ージアミノジフェニルエーテル、4, 4'ージ アミノジフェニルエーテル、3,4'-ジアミノジフェ ニルメタン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、 3, 4'ージアミノジフェニルスルホン、4, 4'ージ アミノジフェニルスルホン、1,4-ビス(4-アミノ フェノキシ)ベンゼンである。これらは単独で又は2種 以上を組み合わせて使用される。

【0058】一般式(8)~(11)のR<sup>21</sup>は水素、ま たは炭素数1~20の有機基を表している。得られるポ ジ型感光性樹脂前駆体溶液の安定性からは、R21は有機 基が好ましいが、アルカリ水溶液の溶解性より見ると水 素が好ましい。本発明においては、水素原子とアルキル 基を混在させることができる。このR<sup>21</sup>の水素と有機基 の量を制御することで、アルカリ水溶液に対する溶解速 度が変化するので、この調整により適度な溶解速度を有 30 したポジ型感光性樹脂前駆体組成物を得ることができ る。好ましい範囲は、R21の10%~90%が水素原子 であることである。またR21の炭素数が20を越えると アルカリ水溶液に溶解しなくなる。以上よりR21は、炭 素数1~16までの炭化水素基を少なくとも1つ以上含 有し、その他は水素原子であることがより好ましい。 【0059】一般式(8)、一般式(9)の構造成分で ある-NH- (R<sup>22</sup>) m-Xは、下記一般式(12)で 示されることが好ましく、これらは、末端封止剤である 1級モノアミンに由来する成分である。Xは、フェノー 40 ル性水酸基、スルホン酸基、チオール基より選ばれる基 を少なくとも一つ有する2から8価の有機基が好まし く、さらに好ましくは、フェノール性水酸基、チオール 基より選ばれる基を少なくとも一つ有する2から8価の

[0060] 【化20】

有機基が好ましい。

$$\begin{array}{c|c}
 & (R^{23})_{p1} \\
\hline
 & (R^{23})_{p1} \\
\hline
 & (R^{24})_{q1} \\
\hline
 & (R^{24})_{q1}
\end{array}$$
(1 2)

【0061】また、一般式 (10)、一般式 (11) の 構造成分である-CO- (R<sup>22</sup>) m1-Yは、一般式 (1 2)、一般式(13)で示されることが好ましく、これ らは、末端封止剤である酸無水物、モノカルボン酸、モ 10 ノ酸クロリド化合物、モノ活性エステル化合物から選ば れるものに由来する成分である。Yはカルボキシル基、\*

\*フェノール性水酸基、スルホン酸基、チオール基より選 ばれる基を少なくとも一つ有する2から8価の有機基が 好ましく、さらに好ましくはフェノール性水酸基、チオ ール基より選ばれる基を少なくとも一つ有する2から8 価の有機基が好ましい。また一般式 (10)、一般式 (11)を構成するYは一般式(13)で表される末端 封止基のみ、一般式(14)で表される末端封止基の み、一般式(13)、一般式(14)の両方を含むもの のいずれであってもよい。

## [0062] 【化21】

$$\begin{array}{c|c}
 & (R^{23})_{p1} \\
 & C \\
 & (R^{23})_{m1} & (R^{23})_{m1} \\
 & (R^{25}OOC)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & (R^{24})_{q1} \\
 & (R^{24})_{q1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & (R^{25}OOC)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & (R^{25}OOC)
\end{array}$$

【0063】一般式(12)、一般式(13)、一般式 (14) 中、 $R^{22}$ は $-CR^{28}R^{29}$ -、 $-CH_2O$ -、-CH2SO2-より選ばれる2価の基を示し、R<sup>28</sup>、R<sup>29</sup> は水素原子、水酸基、炭素数1から10までの炭化水素 基より選ばれる1価の基を示す。R<sup>1</sup>は水素原子、炭素 数1から10までの炭化水素基より選ばれる1価の基を 示す。なかでも水素原子、炭素数1から4の炭化水素基 30 が好ましく、特に好ましくは水素原子、メチル基、t-ブチル基である。R<sup>26</sup>、R<sup>27</sup>は、水素原子、炭素数1か ら4までの炭化水素基より選ばれる1価の基、あるい は、R<sup>26</sup>とR<sup>27</sup>が直接結合した環構造を示す (例えばナ ジイミド環等)。また、R<sup>23</sup>、R<sup>24</sup>は水素原子、水酸 基、カルボキシル基、スルホン酸基、チオール基、炭素 数1から10までの炭化水素基より選ばれ、少なくとも - つは水酸基、カルボキシル基、スルホン酸基、チオー ル基を示す。A1、B1、C1は炭素原子、または窒素 原子であり、各々同じでも異なっていてもよい。m1は 0から10まで整数であり、好ましくは0から4の整数 である。11は0または1であり、好ましくは0であ る。p1は0または1であり、好ましくは0である。q 1は1~3までの整数であり、好ましくは1及び2であ る。 r 1、 s 1、 t 1は0または1である。

【0064】一般式(12)に関する1級モノアミンと は、具体的には、5-アミノ-8-ヒドロキシキノリ ン、4-アミノ-8-ヒドロキシキノリン、1-ヒドロ キシー8-アミノナフタレン、1-ヒドロキシー7-ア

ン、1-ヒドロキシー5-アミノナフタレン、1-ヒド ロキシー4-アミノナフタレン、1-ヒドロキシー3-アミノナフタレン、1-ヒドロキシ-2-アミノナフタ レン、1-アミノー7-ヒドロキシナフタレン、2-ヒ ドロキシー 7ーアミノナフタレン、2ーヒドロキシー6 ーアミノナフタレン、2-ヒドロキシ-5-アミノナフ タレン、2-ヒドロキシ-4-アミノナフタレン、2-ヒドロキシー3-アミノナフタレン、1-アミノ-2-ヒドロキシナフタレン、1-カルボキシ-8-アミノナ フタレン、1-カルボキシ-7-アミノナフタレン、1 -カルボキシー6-アミノナフタレン、1-カルボキシ -5-アミノナフタレン、1-カルボキシ-4-アミノ ナフタレン、1-カルボキシ-3-アミノナフタレン、 1-カルボキシー2-アミノナフタレン、1-アミノー 7-カルポキシナフタレン、2-カルボキシー7-アミ ノナフタレン、2-カルボキシー6-アミノナフタレ ン、2-カルボキシー5-アミノナフタレン、2-カル ボキシー4-アミノナフタレン、2-カルボキシ-3-アミノナフタレン、1-アミノ-2-カルボキシナフタ レン、2-アミノニコチン酸、4-アミノニコチン酸、 5-アミノニコチン酸、6-アミノニコチン酸、4-ア ミノサリチル酸、5-アミノサリチル酸、6-アミノサ リチル酸、3ーアミノーo-トルイック酸、アメライ ド、2-アミノ安息香酸、3-アミノ安息香酸、4-ア ミノ安息香酸、2-アミノベンゼンスルホン酸、3-ア ミノベンゼンスルホン酸、4-アミノベンゼンスルホン ミノナフタレン、1-ヒドロキシ-6-アミノナフタレ 50 酸、3-アミノ-4,6-ジヒドロキシピリミジン、2

ーアミノフェノール、3ーアミノフェノール、4ーアミ ノフェノール、5-アミノ-8-メルカプトキノリン、 4-アミノ-8-メルカプトキノリン、1-メルカプト -8-アミノナフタレン、1-メルカプト-7-アミノ ナフタレン、1-メルカプト-6-アミノナフタレン、 1-メルカプト-5-アミノナフタレン、1-メルカプ トー4ーアミノナフタレン、1ーメルカプトー3ーアミ ノナフタレン、1ーメルカプト-2-アミノナフタレ ン、1-アミノ-7-メルカプトナフタレン、2-メル カプトー7ーアミノナフタレン、2ーメルカプトー6ー 10 アミノナフタレン、2ーメルカプト-5-アミノナフタ レン、2ーメルカプトー4ーアミノナフタレン、2ーメ ルカプト-3-アミノナフタレン、1-アミノ-2-メ ルカプトナフタレン、3-アミノー4、6-ジメルカプ トピリミジン、2-アミノチオフェノール、3-アミノ チオフェノール、4ーアミノチオフェノール等が挙げら れる。

【0065】これらのうち、5-アミノ-8-ヒドロキ シキノリン、1-ヒドロキシ-7-アミノナフタレン、 1ーヒドロキシー6ーアミノナフタレン、1ーヒドロキ シー5-アミノナフタレン、1-ヒドロキシー4-アミ ノナフタレン、2ーヒドロキシー7ーアミノナフタレ ン、2-ヒドロキシー6-アミノナフタレン、2-ヒド ロキシー5-アミノナフタレン、1-カルボキシー7-アミノナフタレン、1-カルボキシー6-アミノナフタ レン、1-カルボキシ-5-アミノナフタレン、2-カ ルボキシー7ーアミノナフタレン、2-カルボキシー6 ーアミノナフタレン、2-カルボキシ-5-アミノナフ タレン、2-アミノ安息香酸、3-アミノ安息香酸、4 ーアミノ安息香酸、4ーアミノサリチル酸、5ーアミノ サリチル酸、6-アミノサリチル酸、2-アミノベンゼ ンスルホン酸、3-アミノベンゼンスルホン酸、4-ア ミノベンゼンスルホン酸、3-アミノー4, 6-ジヒド ロキシピリミジン、2-アミノフェノール、3-アミノ フェノール、4-アミノフェノール、2-アミノチオフ ェノール、3-アミノチオフェノール、4-アミノチオ フェノール等が好ましい。これらは単独で又は2種以上 を組み合わせて使用される。

【0066】一般式 (13) 及び一般式 (14) に関す る酸無水物、モノカルボン酸、モノ酸クロリド化合物、 モノ活性エステル化合物の具体例は、無水フタル酸、無 水マレイン酸、ナジック酸、シクロヘキサンジカルボン 酸無水物、3-ヒドロキシフタル酸無水物等の酸無水 物、2-カルボキシフェノール、3-カルボキシフェノ ール、4-カルボキシフェノール、2-カルボキシチオ フェノール、3-カルボキシチオフェノール、4-カル ボキシチオフェノール、1-ヒドロキシ-8-カルボキ シナフタレン、1-ヒドロキシ-7-カルボキシナフタ レン、1-ヒドロキシー6-カルボキシナフタレン、1 ーヒドロキシー5ーカルボキシナフタレン、1ーヒドロ 50

キシー4-カルボキシナフタレン、1-ヒドロキシー3 ーカルボキシナフタレン、1-ヒドロキシー2-カルボ キシナフタレン、1-メルカプト-8-カルボキシナフ タレン、1-メルカプト-7-カルボキシナフタレン、 1-メルカプトー6-カルボキシナフタレン、1-メル カプト-5-カルボキシナフタレン、1-メルカプト-4-カルボキシナフタレン、1-メルカプト-3-カル ボキシナフタレン、1-メルカプト-2-カルボキシナ フタレン、2ーカルボキシベンゼンスルホン酸、3ーカ ルボキシベンゼンスルホン酸、4-カルボキシベンゼン スルホン酸等のモノカルボン酸類及びこれらのカルボキ シル基が酸クロリド化したモノ酸クロリド化合物及び、 テレフタル酸、フタル酸、マレイン酸、シクロヘキサン ジカルボン酸、3-ヒドロキシフタル酸、5-ノルボル ネン-2, 3-ジカルボン酸、1, 2-ジカルボキシナ フタレン、1, 3-ジカルボキシナフタレン、1, 4-ジカルボキシナフタレン、1,5-ジカルボキシナフタ レン、1,6-ジカルボキシナフタレン、1,7-ジカ ルボキシナフタレン、1,8-ジカルボキシナフタレ ン、2,3ージカルボキシナフタレン、2,6ージカル ボキシナフタレン、2, 7-ジカルボキシナフタレン等 のジカルボン酸類のモノカルボキシル基だけが酸クロリ ド化したモノ酸クロリド化合物、モノ酸クロリド化合物 とN-ヒドロキシベンゾトリアゾールやN-ヒドロキシ -5-ノルボルネン-2、3-ジカルボキシイミドとの 反応により得られる活性エステル化合物、が挙げられ る。

【0067】これらのうち、無水フタル酸、無水マレイ ン酸、ナジック酸、シクロヘキサンジカルボン酸無水 物、3-ヒドロキシフタル酸無水物等の酸無水物、3-30 カルボキシフェノール、4-カルボキシフェノール、3 ーカルボキシチオフェノール、4-カルボキシチオフェ ノール、1ーヒドロキシー7ーカルボキシナフタレン、 1-ヒドロキシー6-カルボキシナフタレン、1-ヒド ロキシー5-カルボキシナフタレン、1-メルカプトー 7-カルボキシナフタレン、1-メルカプトー6-カル ボキシナフタレン、1-メルカプト-5-カルボキシナ フタレン、3-カルボキシベンゼンスルホン酸、4-カ ルボキシベンゼンスルホン酸等のモノカルボン酸類及び これらのカルボキシル基が酸クロリド化したモノ酸クロ リド化合物及びテレフタル酸、フタル酸、マレイン酸、 シクロヘキサンジカルボン酸、1、5-ジカルボキシナ フタレン、1,6ージカルボキシナフタレン、1,7ー ジカルボキシナフタレン、2,6-ジカルボキシナフタ レン等のジカルボン酸類のモノカルボキシル基だけが酸 クロリド化したモノ酸クロリド化合物、モノ酸クロリド 化合物とN-ヒドロキシベンソトリアゾールやN-ヒド ロキシー5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミ ドとの反応により得られる活性エステル化合物等が好ま しい。これらは単独で又は2種以上を組み合わせて使用

40

20

22

される。一般式(12)で表される成分(一般式 (8)、(9)のX成分)の導入割合は、その元成分で ある末端封止剤の1級モノアミン成分で換算すると、全 アミン成分に対して、0.1~60モル%の範囲が好ま しく、特に好ましくは5~50モル%である。

【0068】一般式(13)や一般式(14)で表される成分(一般式(10)、(11)のY成分)の導入割合は、その元成分である末端封止剤の酸無水物、モノカルボン酸、モノ酸クロリド化合物、モノ活性エステル化合物成分で換算すると、ジアミン成分に対して、0.1~60モル%の範囲が好ましく、特に好ましくは5~55モル%である。

【0069】一般式(8)及び一般式(9)または一般式(10)及び一般式(11)のnnは本発明のポリマーの構造単位の繰り返し数を示しており、10~10000の範囲であることが好ましい。

【0070】さらに、基板との接着性を向上させるために、耐熱性を低下させない範囲でR<sup>19</sup>、R<sup>20</sup>にシロキサン構造を有する脂肪族の基を共重合してもよい。具体的には、ジアミン成分として、ビス(3-アミノプロピル)テトラメチルジシロキサン、ビス(p-アミノーフェニル)オクタメチルペンタシロキサンなどを1~10モル%共重合したものなどがあげられる。

【0071】本発明の(a)成分ポリマーのうち、ポリマー主鎖末端にアルカリ可溶性基を有するものは、一般式(8)および/または一般式(9)、あるいは一般式(10)および/または一般式(11)で表される構造単位のみからなるものであっても良いし、他の構造単位との共重合体あるいはブレンド体であっても良い。その際、一般式(8)および/または一般式(9)、あるい30は一般式(10)および/または一般式(11)で表される構造単位を50モル%以上含有していることが好ましい。共重合あるいはブレンドに用いられる構造単位の種類および量は最終加熱処理によって得られるポリイミド系ポリマーの耐熱性を損なわない範囲で選択することが好ましい。

【0072】本発明の上記一般式(8)~(11)で表される(a)成分ポリマーは、ジアミンの一部をモノアミンである末端封止剤に置き換えてまたは、酸二無水物を、モノカルボン酸、酸無水物、モノ酸クロリド化合物、モノ活性エステル化合物である末端封止剤に置き換えて、公知の方法を利用して合成される。例えば、低温中でテトラカルボン酸2無水物とジアミン化合物(一部をモノアミンである末端封止剤に置換)を反応させる方法、低温中でテトラカルボン酸二無水物(一部を酸無水物またはモノ酸クロリド化合物あるいはモノ活性エステル化合物である末端封止剤に置換)とジアミン化合物を反応させる方法、テトラカルボン酸2無水物とアルコールとによりジエステルを得、その後ジアミン(一部をモノアミンである末端封止剤に置換)と縮合剤の存在下で 50 UTTriML-P、TriML-35XL、TriM

反応させる方法、テトラカルボン酸 2 無水物とアルコールとによりジエステルを得、その後残りのジカルボン酸を酸クロリド化し、ジアミン (一部をモノアミンである末端封止剤に置換)と反応させる方法などの方法を利用して合成することができる。

【0073】また、ポリマー中に導入された、本発明に使用の末端封止剤は、以下の方法で容易に検出できる。例えば、末端封止剤が導入されたポリマーを、酸性溶液に溶解し、ポリマーの構成単位であるアミン成分と酸無水成分に分解、これをガスクロマトグラフィー(GC)や、NMR測定することにより、本発明に使用の末端封止剤を容易に検出できる。これとは別に、末端封止剤が導入されたポリマー成分を直接、熱分解ガスクロクロマトグラフ(PGC)や赤外スペクトル及びC13NMRスペクトル測定でも、容易に検出可能である。

【0074】本発明の(a)成分のポリマーは、上記一般式(3)、一般式(8)~(11)で表される構造単位を主成分としており、これらのうち、好ましくは、上記一般式(3)で表される構造単位を主成分としているものである。また、特に好ましくは、一般式(3)で表される構造単位を含有しかつ、一般式(8)~(11)で表される構造単位から選ばれる1種以上を含有する構造単位を主成分とするものである。

【0075】この場合、一般式(3)表される構造単位 と、一般式(8)~(11)で表される構造単位は共重 合体あるいはブレンド体であっても良い。その際、一般 式(3)で表される単位を1モル%以上含有しているこ とが好ましく、特に好ましくは、5モル%以上である。 【0076】本発明で使用される一般式(1)で表され る基を含有する熱架橋性化合物(b)としては、たとえ ば、上記有機基を1つ有するものとしてML-26X、 ML-24X、ML-236TMP、4-メチロール3 M6C、ML-MC、ML-TBC(商品名、本州化学 工業(株)製)等、2つ有するものとしてDM-BI2 5X-F, 46DMOC, 46DMOIPP, 46DM OEP (商品名、旭有機材工業 (株) 製)、DML-M BPC, DML-MBOC, DML-OCHP, DML -PC, DML-PCHP, DML-PTBP, DML -34X, DML-EP, DML-POP, DML-OC、ジメチロールーBisーC、ジメチロールーBis OC-P, DML-BisOC-Z, DML-BisO CHP-Z, DML-PFP, DML-PSBP, DM L-MB25, DML-MTrisPC, DML-Bi s 2 5 X - 3 4 X L , DML - B i s 2 5 X - P C H P (商品名、本州化学工業(株)製)、"ニカラック"M X-290 (商品名、(株) 三和ケミカル製)、2,6 ージメトキシメチルー4-t-ブチルフェノール、2, 6-ジメトキシメチル-p-クレゾール、2,6-ジア セトキシメチルーp-クレゾール等、3つ有するものと

L-TrisCR-HAP (商品名、本州化学工業 (株) 製) 等、4つ有するものとしてTM-BIP-A (商品名、旭有機材工業 (株) 製)、 TML-BP、T ML-HQ, TML-pp-BPF, TML-BPA, TMOM-BP (商品名、本州化学工業 (株) 製)、" ニカラック"MX-280、"ニカラック"MX-27 0 (商品名、(株)三和ケミカル製)等、6つ有するも のとしてHML-TPPHBA、HML-TPHAP (商品名、本州化学工業(株)製)が挙げられる。

【0077】これらのうち、本発明では一般式(1)で 10 製)等が挙げられる。 表される基を少なくとも2つ含有するものが好ましく、 特に好ましくは、2つ有するものとして46DMOC、 46DMOEP (商品名、旭有機材工業 (株) 製)、D ML-MBPC, DML-MBOC, DML-OCH P, DML-PC, DML-PCHP, DML-PTB P, DML-34X, DML-EP, DML-POP, ジメチロールーBisOC-P、DML-PFP、DM L-PSBP、DML-MTrisPC (商品名、本州 化学工業(株)製)、"ニカラック"MX-290(商 品名、(株) 三和ケミカル製)、2,6-ジメトキシメ チルー4-t-ブチルフェノール、2,6-ジメトキシ メチル-p-クレゾール、2,6-ジアセトキシメチル -p-クレゾール等、3つ有するものとしてTriML -P、TriML-35XL(商品名、本州化学工業 (株) 製) 等、4つ有するものとしてTM-BIP-A (商品名、旭有機材工業 (株) 製)、 TML-BP、T\*

\*ML-HQ, TML-pp-BPF, TML-BPA. TMOM-BP (商品名、本州化学工業 (株) 製)、" ニカラック"MX-280、"ニカラック"MX-27 0 (商品名、(株) 三和ケミカル製) 等、6つ有するも のとしてHML-TPPHBA、HML-TPHAP (商品名、本州化学工業(株)製)等が挙げられる。ま た、さらに好ましくは上記一般式 (2) で表される基を 有する化合物である"ニカラック"MX-280、"ニ カラック"MX-270 (商品名、(株) 三和ケミカル

24

【0078】これらの熱架橋化合物を添加することで、 得られる樹脂組成物は、露光前はアルカリ現像液にほと んど溶解せず、露光すると容易にアルカリ現像液に溶解 するために、現像による膜減りが少なく、かつ短時間で 現像ができ、加えて、キュア後の収縮率が少なくなる。 【0079】特に熱架橋化合物が一般式(2)で表され る基を含有する化合物の場合、芳香族の熱架橋化合物と 比較して、露光波長の光に対して吸収がきわめて小さ く、それ故、露光すると感光剤の感光効率が上がり、容 易にアルカリ現像液に溶解するようになり、短時間で現 像ができる。また、脂肪族系に比較して脂環式系である ために耐熱性に優れる。

【0080】これら架橋性化合物は、以下のように、べ ンゼン環に直接付加する反応機構によって架橋する。 [0081] 【化22】

20

【0082】下記に本発明で使用するのに特に好ましい 代表的な熱架橋性化合物の構造を示した。

[0083] 【化23】

【0084】このような熱架橋性化合物の添加量としては、ポリマー100重量部に対して、好ましくは0.5から50重量部であり、さらに好ましくは3から40重量部の範囲である。

【0085】本発明に添加される(c)のエステル化し Z、BisOCP-IPZ、BisP-CP、BisFたキノンジアジド化合物としては、フェノール性水酸基 S-2P、BisRS-3P、BisP-OCHP、タを有する化合物にナフトキノンジアジドのスルホン酸が チレントリスーFR-CR、BisRS-26X、DMエステルで結合した化合物が好ましい。ここで用いられ 50 L-MBPC、DML-MBOC、DML-OCHP、

るフェノール性水酸基を有する化合物としては、BisーZ、BisPーEZ、TekP-4HBPA、TrisP-HAP、TrisP-HAP、BisOCHP-Z、BisP-MZ、BisP-PZ、BisP-IPZ、BisOCP-IPZ、BisP-CP、BisRS-2P、BisRS-3P、BisP-OCHP、メチレントリスーFR-CR、BisRS-26X、DML-MBPC、DML-OCHP

DML-PCHP, DML-PC, DML-PTBP, DML-34X、DML-EP、DML-POP、ジメ チロールーBisOC-P、DML-PFP、DML-PSBP, DML-MTrisPC, TriML-P, TriML-35XL, TML-BP, TML-HQ, TML-pp-BPF, TML-BPA, TMOM-B P、HML-TPPHBA、HML-TPHAP (商品 名、本州化学工業(株)製)、BIR-OC、BIP-PC, BIR-PC, BIR-PTBP, BIR-PC HP, BIP-BIOC-F, 4PC, BIR-BIP C-F, TEP-BIP-A, 46DMOC, 46DM OEP、TM-BIP-A(商品名、旭有機材工業

(株) 製)、2,6-ジメトキシメチル-4-t-ブチ ルフェノール、2,6-ジメトキシメチル-p-クレゾ ール、2, 6 - ジ P  $\tau$  +  $\tau$  ナフトール、テトラヒドロキシベンゾフェノン、没食子 酸メチルエステル、ビスフェノールA、メチレンビスフ エノール、BisP-AP (商品名、本州化学工業

(株) 製) などの化合物に4-ナフトキノンジアジドス ルホン酸あるいは5-ナフトキノンジアジドスルホン酸 20 をエステル結合で導入したものが好ましいものとして例 示することが出来るが、これ以外の化合物を使用するこ ともできる。

【0086】また、本発明で用いるナフトキノンジアジ ド化合物の分子量が1000より大きくなると、その後 の熱処理においてナフトキノンジアジド化合物が十分に 熱分解しないために、得られる膜の耐熱性が低下する、 機械特性が低下する、接着性が低下するなどの問題が生 じる可能性がある。このような観点より見ると、好まし いナフトキノンジアジド化合物の分子量は1000以下 であり、より好ましくは800以下である。また同様に して好ましい分子量の下限は300以上、より好ましく は350以上である。このようなナフトキノンジアジド 化合物の添加量としては、ポリマー100重量部に対し て、好ましくは1から50重量部である。

【0087】本発明においては、4-ナフトキノンジア ジドスルホニルエステル化合物、5ーナフトキノンジア ジドスルホニルエステル化合物のどちらも好ましく使用 することが出来るが、露光する波長によって4ーナフト キノンジアジドスルホニル、エステル化合物、5-ナフ トキノンジアジドスルホニルエステル化合物を選択する ことが好ましい。また、同一分子中に4ーナフトキノン ジアジドスルホニル基、5-ナフトキノンジアジドスル ホニル基を併用した、ナフトキノンジアジドスルホニル エステル化合物を得ることもできるし、4ーナフトキノ ンジアジドスルホニルエステル化合物と5ーナフトキノ ンジアジドスルホニルエステル化合物を混合して使用す ることもできる。

【0088】本発明のナフトキノンジアジド化合物は、 フェノール性水酸基を有する化合物と、キノンジアジド 50 合物の添加量としては、ポリマー100重量部に対し

スルホン酸化合物とのエステル化反応によって、合成す ることが可能であって、公知の方法により合成すること ができる。

【0089】このようなナフトキノンジアジドを使用す ることで解像度、感度、残膜率が向上する。

【0090】また、必要に応じて上記、感光性耐熱性前 駆体組成物の感度を向上させる目的で、フェノール性水 酸基を有する化合物を添加することができる。

【0091】このフェノール性水酸基を有する化合物と 10 しては、たとえば、Bis-Z、BisOC-Z、Bi sOPP-Z, BisP-CP, Bis26X-Z, B isOTBP-Z, BisOCHP-Z, BisOCR -CP、BisP-MZ、BisP-EZ、Bis26 X-CP, B i s P-PZ, B i s P-IPZ, B i s CR-IPZ, BisOCP-IPZ, BisOIPP -CP、Bis26X-IPZ、BisOTBP-C P、TekP-4HBPA (テトラキスP-DO-BP A) 、TrisP-HAP、TrisP-PA、Bis OFP-Z, BisRS-2P, BisPG-26X, BisRS-3P, BisOC-OCHP, BisPC -OCHP, Bis25X-OCHP, Bis26X-OCHP, BisOCHP-OC, Bis236T-O CHP、メチレントリスーFR-CR、BisRS-2 6X、BisRS-OCHP(商品名、本州化学工業 (株) 製)、BIR-OC、BIP-PC、BIR-P C, BIR-PTBP, BIR-PCHP, BIP-B IOC-F, 4PC, BIR-BIPC-F, TEP-BIP-A(商品名、旭有機材工業(株)製)が挙げら れる。

【0092】これらのうち、本発明の好ましいフェノー ル性水酸基を有する化合物としては、たとえば、Bis -Z, BisP-EZ, TekP-4HBPA, Tri sP-HAP, TrisP-PA, BisOCHP-Z, BisP-MZ, BisP-PZ, BisP-IP Z, BisOCP-IPZ, BisP-CP, BisR S-2P, BisRS-3P, BisP-OCHP, X チレントリスーFR-CR、BisRS-26X、BI P-PC, BIR-PC, BIR-PTBP, BIR-BIPC-F等が挙げられる。これらのうち、特に好ま しいフェノール性水酸基を有する化合物としては、たと えば、Bis-Z、TekP-4HBPA、TrisP -HAP, TrisP-PA, BisRS-2P, Bi sRS-3P, BIR-PC, BIR-PTBP, BI R-BIPC-Fである。このフェノール性水酸基を有 する化合物を添加することで、得られる樹脂組成物は、 露光前はアルカリ現像液にほとんど溶解せず、露光する と容易にアルカリ現像液に溶解するために、現像による 膜減りが少なく、かつ短時間で現像が容易になる。

【0093】このようなフェノール性水酸基を有する化

て、好ましくは1から50重量部であり、さらに好ましくは3から40重量部の範囲である。さらに、必要に応じて上記、感光性耐熱性前駆体組成物と基板との塗れ性を向上させる目的で界面活性剤、乳酸エチルやプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどのエステル類、エタノールなどのアルコール類、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトンなどのケトン類、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類を混合しても良い。また、2酸化ケイ素、2酸化チタンなどの無機粒子、あるいはポリイミドの粉末などを添加することも10できる。

【0094】また、シリコンウエハーなどの下地基板との接着性を高めるために、シランカップリング剤、チタンキレート剤などを感光性耐熱性樹脂前駆体組成物のワニスに0.5から10重量%添加したり、下地基板をこのような薬液で前処理したりすることもできる。

【0095】ワニスに添加する場合、メチルメタクリロキシジメトキシシラン、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、などのシランカップリング剤、チタンキレート剤、アルミキレート剤をワニス中のポリマーに対して 200.5から10重量%添加する。

【0096】基板を処理する場合、上記で述べたカップリング剤をイソプロパノール、エタノール、メタノール、水、テトラヒドロフラン、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、乳酸エチル、アジピン酸ジエチルなどの溶媒に0.5から20重量%溶解させた溶液をスピンコート、浸漬、スプレー塗布、蒸気処理などで表面処理をする。場合によっては、その後50℃から300℃までの温度をかけることで、基板と上記カップリング剤 30との反応を進行させる。

【0097】しかしながら上記感光性耐熱性前駆体組成物はアルカリ水溶液に対する(a)成分の溶解を阻害する効果のある化合物として、オニウム塩、ジアリル化合物又はテトラアルキルアンモニウム塩等は含有してはいけない。これらを含有した場合、その後の熱処理でその化合物分解が起こり、酸または塩基が発生し、これが原因で膜が劣化し、得られる膜の耐熱性が低下する、機械特性が低下する、接着性が低下する等の問題が生じる可能性がある。

【0098】次に、本発明の感光性耐熱性前駆体組成物を用いて耐熱性樹脂パターンを形成する方法について説明する。

【0099】感光性耐熱性前駆体組成物を基板上に塗布する。基板としてはシリコンウエハー、セラミックス類、ガリウムヒ素などが用いられるが、これらに限定されない。塗布方法としてはスピンナを用いた回転塗布、スプレー塗布、ロールコーティングなどの方法がある。また、塗布膜厚は、塗布手法、組成物の固形分濃度、粘度などによって異なるが通常、乾燥後の膜厚が、0.1

から150μmになるように塗布される。

【0100】次に感光性耐熱性前駆体組成物を塗布した 基板を乾燥して、感光性耐熱性前駆体組成物皮膜を得 る。乾燥はオーブン、ホットプレート、赤外線などを使 用し、50度から150度の範囲で1分から数時間行う のが好ましい。

【0101】次に、この感光性耐熱性前駆体組成物皮膜上に所望のパターンを有するマスクを通して化学線を照射し、露光する。露光に用いられる化学線としては紫外線、可視光線、電子線、X線などがあるが、本発明では水銀灯のi線(365nm)、h線(405nm)、g線(436nm)を用いるのが好ましい。

【0102】耐熱性樹脂のパターンを形成するには、露 光後、現像液を用いて露光部を除去することによって達 成される。現像液としては、テトラメチルアンモニウム の水溶液、ジエタノールアミン、ジエチルアミノエタノ ール、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリ ウム、炭酸カリウム、トリエチルアミン、ジエチルアミ ン、メチルアミン、ジメチルアミン、酢酸ジメチルアミ ノエチル、ジメチルアミノエタノール、ジメチルアミノ エチルメタクリレート、シクロヘキシルアミン、エチレ ンジアミン、ヘキサメチレンジアミンなどのアルカリ性 を示す化合物の水溶液が好ましい。また場合によって は、これらのアルカリ水溶液にN-メチル-2-ピロリ ドン、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチ ルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、y ープチロラ クロン、ジメチルアクリルアミドなどの極性溶媒、メタ ノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルコー ル類、乳酸エチル、プロピレングリコールモノメチルエ ーテルアセテートなどのエステル類、シクロペンタノ ン、シクロヘキサノン、イソプチルケトン、メチルイソ ブチルケトンなどのケトン類などを単独あるいは数種を 組み合わせたものを添加してもよい。現像後は水にてリ ンス処理をする。ここでもエタノール、イソプロピルア ルコールなどのアルコール類、乳酸エチル、プロピレン グリコールモノメチルエーテルアセテートなどのエステ ル類などを水に加えてリンス処理をしても良い。

【0103】現像後、200度から500度の温度を加えて耐熱性樹脂皮膜に変換する。この加熱処理は温度を選び、段階的に昇温するか、ある温度範囲を選び連続的に昇温しながら5分から5時間実施する。一例としては、130度、200度、350度で各30分づつ熱処理する。あるいは室温より400度まで2時間かけて直線的に昇温するなどの方法が挙げられる。

【0104】本発明による感光性耐熱性前駆体組成物により形成した耐熱性樹脂皮膜は、半導体のパッシベーション膜、半導体素子の保護膜、高密度実装用多層配線の層間絶縁膜などの用途に用いられる。

【0105】また本発明の組成物を用いて表示装置に形 50 成される絶縁層は、基板上に形成された第一電極と、前

記第一電極に対向して設けられた第二電極とを含む表示 装置に関するものであり、具体的には例えば、LCD、 ECD、ELD、有機電界発光素子を用いた表示装置

(有機電界発光装置)などが該当する。有機電界発光装置とは、基板上に形成された第一電極と、第一電極上に 形成された少なくとも有機化合物からなる発光層を含む 薄膜層と、薄膜層上に形成された第二電極とを含む有機 電界発光素子からなる表示装置である。

#### [0106]

【実施例】以下実施例および技術をあげて本発明を説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるものではない。なお、実施例中の感光性耐熱性樹脂前駆体組成物の評価は以下の方法により行った。

【0107】感光性ポリイミド前駆体膜の作製6インチシリコンウエハー上に、感光性耐熱性樹脂前駆体組成物(以下ワニスと呼ぶ)をプリベーク後の膜厚が7μmとなるように塗布し、ついでホットプレート(東京エレクトロン(株)製Mark-7)を用いて、120℃で3分プリベークすることにより、感光性ポリイミド前駆体膜を得た。

#### 【0108】膜厚の測定方法

大日本スクリーン製造(株)製ラムダエースSTM-602を使用し、屈折率1.64で測定を行った。 露光

露光機(GCA社製i線ステッパーDSW-8000)に、パターンの切られたレチクルをセットし、露光時間を変化させ(365nmの強度)てi線露光を行った。 現像

東京エレクトロン(株)製Mark-7の現像装置を用い、50回転で水酸化テトラメチルアンモニウムの2.38%水溶液を10秒間噴霧した。この後、0回転で60秒間静置し、400回転で水にてリンス処理、3000回転で10秒振り切り乾燥した。

## 【0109】残膜率の算出

残膜率は以下の式に従って算出した。

残膜率 (%) =現像後の膜厚÷プリベーク後の膜厚×1 00

#### 感度の算出

露光、現像後、 $50 \mu$  mのライン・アンド・スペースパターン(1L/1S)を1対1の幅に形成する露光時間 40 (以下、これを最適露光時間という)を求めた。

#### 解像度の算出

露光、現像後、 $50\mu$ mのライン・アンド・スペースパターン(1L/1S)を1対1の幅に形成する最適露光時間における最小のパターン寸法を解像度とした。

#### 【0110】収縮率の算出

作製された感光性ポリイミド前駆体膜を、光洋リンドバ

ーグ (株) 製イナートオーブン I NH-21CDを用いて、窒素気流下 (酸素濃度20 p p m以下)、140 $^{\circ}$ で30分、その後350 $^{\circ}$ まで1時間で昇温して350 $^{\circ}$ で1時間熱処理をし、キュア膜を作製した。収縮率は以下の式に従って算出した。

32

収縮率 (%) = (プリベーク後の膜厚-キュア後の膜厚) ÷プリベーク後の膜厚×100。

【0111】合成例1 ヒドロキシル基含有酸無水物(a)の合成

乾燥窒素気流下、2,2ービス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパン(BAHF)
 18.3g(0.05モル)とアリルグリシジルエーテル34.2g(0.3モル)をガンマブチロラクトン(GBL)100gに溶解させ、-15℃に冷却した。ここにGBL50gに溶解させた無水トリメリット酸クロリド22.1g(0.11モル)を反応液の温度が0℃を越えないように滴下した。滴下終了後、0℃で4時間反応させた。この溶液をロータリーエバポレーターで濃縮して、トルエン11に投入して酸無水物(a)を得20た。

## [0112]

【化24】

【0113】合成例2 ヒドロキシル基含有ジアミン化合物(b)の合成

BAHF18.3g(0.05モル)をアセトン100ml、プロピレンオキシド17.4g(0.3モル)に溶解させ、-15℃に冷却した。ここに4ーニトロベンゾイルクロリド20.4g(0.11モル)をアセトン100mlに溶解させた溶液を滴下した。滴下終了後、-15℃で4時間反応させ、その後室温に戻した。析出した白色固体をろ別し、50℃で真空乾燥した。

【0114】固体30gを300mlのステンレスオートクレープに入れ、メチルセルソルプ250mlに分散させ、5%パラジウムー炭素を2g加えた。ここに水素を風船で導入して、還元反応を室温で行った。約2時間後、風船がこれ以上しぼまないことを確認して反応を終了させた。反応終了後、ろ過して触媒であるパラジウム化合物を除き、ロータリーエバポレーターで濃縮し、ジアミン化合物(b)を得た。得られた固体をそのまま反応に使用した。

[0115]

【化25】

【0116】合成例3 ヒドロキシル基含有ジアミン化 合物(c)の合成

2-アミノ-4-ニトロフェノール15. 4g (0.1 モル)をアセトン50ml、プロピレンオキシド30g こにイソフタル酸クロリド11.2g(0.055モ ル)をアセトン60mlに溶解させた溶液を徐々に滴下 した。滴下終了後、-15℃で4時間反応させた。その 後、室温に戻して生成している沈殿をろ過で集めた。

【0117】この沈殿をGBL200mlに溶解させ て、5%パラジウムー炭素3gを加えて、激しく攪拌し た。ここに水素ガスを入れた風船を取り付け、室温で水 素ガスの風船がこれ以上縮まない状態になるまで攪拌を 続け、さらに2時間水素ガスの風船を取り付けた状態で 攪拌した。攪拌終了後、ろ過でパラジウム化合物を除 き、溶液をロータリーエバポレーターで半量になるまで **濃縮した。ここにエタノールを加えて、再結晶を行い、** 目的の化合物の結晶を得た。

[0118]

【化26】

$$H_2N$$
  $H_2N$   $H_2N$ 

【0119】合成例4 ヒドロキシル基含有ジアミン化 30 合物 (d) の合成

2-アミノ-4-ニトロフェノール15. 4g (0.1 モル)をアセトン100ml、プロピレンオキシド1 7. 4g(0.3モル)に溶解させ、-15℃に冷却し\*

\*た。ここに4-ニトロベンゾイルクロリド20、4g (0.11モル)をアセトン100mlに溶解させた溶 液を徐々に滴下した。滴下終了後、-15℃で4時間反 応させた。その後、室温に戻して生成している沈殿をろ (0.34モル)に溶解させ、-15℃に冷却した。こ 10 過で集めた。この後、合成例2と同様にして目的の化合 物の結晶を得た。

[0120]

【化27】

$$H_2N$$
  $H_2$   $H_2$   $H_2$   $H_2$   $H_3$   $H_4$ 

【0121】合成例5 キノンジアジド化合物(1)の 合成

乾燥窒素気流下、BisRS-2P (商品名、本州化学 工業(株)製) 16.10g(0.05モル)と5ーナ フトキノンジアジドスルホニル酸クロリド26.86g (0.1モル)を1,4-ジオキサン450gに溶解さ せ、室温にした。ここに、1、4-ジオキサン50gと 混合させたトリエチルアミン10.12gを系内が35 ℃以上にならないように滴下した。滴下後30℃で2時 間攪拌した。トリエチルアミン塩を濾過し、ろ液を水に 投入させた。その後、析出した沈殿をろ過で集めた。こ の沈殿を真空乾燥機で乾燥させ、キノンジアジド化合物 (1)を得た。

[0122]

【化28】

20

【0123】合成例6 キノンジアジド化合物(2)の 合成

乾燥窒素気流下、TrisP-HAP(商品名、本州化 学工業 (株) 製)、15.31g(0.05モル)と5 ーナフトキノンジアジドスルホニル酸クロリド40.2 8g (0. 15モル) を1, 4ージオキサン450gに 溶解させ、室温にした。ここに、1,4-ジオキサン5 0gと混合させたトリエチルアミン15.18gを用 い、合成例5と同様にしてキノンジアジド化合物 (2) を得た。

[0124]

【化29】

$$QO \stackrel{CH_3}{\bigcirc} OQ \qquad Q= \qquad Q_2 \qquad Q_2 \qquad Q_3 \qquad Q_4 \qquad Q_5 \qquad Q_6 \qquad Q_8 \qquad Q_9 \qquad Q_9$$

【0125】合成例7 キノンジアジド化合物(3)の 合成

50 乾燥窒素気流下、BIR-PTBP (商品名、旭有機材

工業(株) 製) 19.72g(0.05モル) と4ーナフトキノンジアジドスルホニル酸クロリド26.86g(0.1モル)を1,4ージオキサン450gに溶解させ、室温にした。ここに、1,4ージオキサン50gと\*

【0127】合成例8 キノンジアジド化合物 (4) の 10 合成

乾燥窒素気流下、ビスフェノールA 11.41g (0.05モル)と5ーナフトキノンジアジドスルホニル酸クロリド26.86g(0.1モル)を1,4ージオキサン450gに溶解させ、室温にした。ここに、1,4ージオキサン50gと混合させたトリエチルアミン10.12gを用い、合成例5と同様にしてキノンジアジド化合物(4)を得た。

[0128]

【化31】

$$QO \leftarrow CH_3$$
 $CH_3$ 
 $Q= CH_3$ 
 $SO_2$ 

【0129】合成例9 2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)へキサフルオロプロパン二無水物のジエチルエステルジクロリド溶液(a)の合成乾燥窒素気流下、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシ

フェニル)へキサフルオロプロパン二無水物35.54 30 g (0.08モル)、エチルアルコール36.9 g (0.8モル)を95℃6時間攪拌反応させた。余剰のエタノールを減圧下、留去して、ピロメリット酸ジエチルエステルを得た。ついで塩化チオニルを95.17g (0.8モル)、テトラヒドロフラン(THF)70gを仕込み40℃で3時間反応させた。つづいて、Nーメチルピロピドン331gを添加し、減圧により、余剰の塩化チオニル及びTHFを除去し、ピロメリット酸ジエチルエステルジクロリド溶液(b)376.86 g

【0130】合成例10 3,3'、4,4'ーベンソフェノンテトラカルボン酸ジエチルエステルジクロリド溶液(b)の合成の合成

(0.08モル)を得た。

乾燥窒素気流下、3,3'、4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物25.78g(0.08モル)、エタノール36.90g(0.8モル)を95℃6時間攪拌反応させた。余剰のエタノールを減圧下、留去して、3,3'、4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸ジエチルエステルを得た。ついで塩化チオニルを95.17g(0.8モル)、テトラヒドロフラン

36 \*混合させたトリエチルアミン10.12gを用い、合成 例5と同様にしてキノンジアジド化合物 (3) を得た。

[0126]

【化30】

(THF) 70gを仕込み40℃で3時間反応させた。 つづいて、Nーメチルピロピドン200gを添加し、減 圧により、余剰の塩化チオニル及びTHFを除去し、 3,3'、4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸 ジエチルエステルジクロリド溶液(b)233.15g (0.08モル)を得た。

【0131】各実施例、比較例に使用したフェノール性 水酸基を有する化合物を下記に示した。

[0132]

【化32】

20

#### 【0133】実施例1

乾燥窒素気流下、4, 4' -ジアミノフェニルエーテル 5. 01g (0. 025 モル)、1, 3 - ビス (3 - アミノプロピル) テトラメチルジシロキサン 1. 24g (0. 005 モル) をN - メチルー2 - ピロリドン (N MP) 50g に溶解させた。ここに合成例 1 で得られた ヒドロキシ基含有酸無水物 (a) 21. 4g (0. 03 モル) をN MP 14g とともに加えて、20  $\mathbb C$  で 1 時間 反応させ、次いで 50  $\mathbb C$  で 4 時間 反応させた。 その後、N、N - ジメチルホルムアミドジメチルアセタール 7. 14g (0. 06 モル) をN MP 5g で希釈した溶液を 10 分かけて滴下した。滴下後、50  $\mathbb C$  で 3 時間 攪拌した。

【0134】得られた溶液40gに合成例5で得られたキノンジアジド化合物(1)2g、熱架橋性化合物"ニカラック"MX-270(商品名、(株)三和ケミカル製)1.2gを加えて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスAを得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜を50作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、

40

収縮率について評価を行った。

## 【0135】実施例2

乾燥窒素気流下、合成例2で得られたヒドロキシル基含 有ジアミン(b) 15.1g (0.025モル)をN-メチルー2-ピロリドン (NMP) 50gに溶解させ た。ここに合成例1で得られたヒドロキシ基含有酸無水 物(a) 17.5g(0.025モル)をピリジン30 gとともに加えて、60℃で6時間反応させた。反応終 了後、溶液を水21に投入して、ポリマー固体の沈殿を ろ過で集めた。ポリマー固体を80℃の真空乾燥機で2 0時間乾燥した。

【0136】このようにして得たポリマーの固体10g を計り、合成例6で得られたキノンジアジド化合物

(2) 2g、熱架橋性化合物DML-MBPC(商品 名、本州化学工業 (株) 製) 2 g、Bis-Z (商品 名、本州化学工業(株)製)1.5g、ビニルトリメト キシシラン1gとをGBL30gに溶解させて感光性ポ リイミド前駆体組成物のワニスBを得た。得られたワニ スを用いて前記のように、シリコンウエハー上に感光性 ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感 20 度、残膜率、解像度、収縮率について評価を行った。

#### 【0137】実施例3

乾燥窒素気流下、合成例3で得られたヒドロキシル基含 有ジアミン化合物 (c) 17g (0.045モル)、 1, 3ービス(3ーアミノプロピル)テトラメチルジシ ロキサン1. 24g (0.005モル) をNMP50g に溶解させた。ここに3, 3', 4, 4'ージフェニル エーテルテトラカルボン酸無水物12.4g(0.04 モル)をNMP21gとともに加えて、20℃で1時間 反応させ、次いで50℃で2時間反応させた。ここに無 30 水マレイン酸 0.98g (0.01モル) を加え、50 ℃で2時間攪拌後、N,Nージメチルホルムアミドジエ チルアセタール14.7g(0.1モル)をNMP5g で希釈した溶液を10分かけて滴下した。滴下後、50 ℃で3時間攪拌した。

【0138】得られた溶液30gに合成例7で得られた キノンジアジド化合物 (3) 1.6 g、熱架橋性化合物 TML-HQ(商品名、本州化学工業(株)製)1gを 溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスCを 得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコン 40 ウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、 現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、収縮率につい て評価を行った。

#### 【0139】実施例4

乾燥窒素気流下、合成例4で得られたヒドロキシル基含 有ジアミン化合物 (d) 6.08g (0.025モル) と4, 4' -ジアミノジフェニルエーテル4. 51g (0.0225モル) と1, 3ービス (3ーアミノプロ ピル) テトラメチルジシロキサン0.62g(0.00 25 モル)をNMP70gに溶解させた。ヒドロキシル 50 g、BIR-PC(商品名、旭有機材工業(株)製)

基含有酸無水物 2 4. 99g (0. 035モル)、3, 3', 4, 4'ービフェニルテトラカルボン酸2無水物 4. 41g(0.015モル)を室温でNMP25gと ともに加え、そのまま室温で1時間、その後50℃で2 時間攪拌した。ついで、グリシジルメチルエーテル1

3.8

7. 6g (0. 2モル) をNMP10gで希釈した溶液 を加え、70℃で6時間攪拌した。

【0140】このポリマー溶液40gに合成例8で得ら れたキノンジアジド化合物(4)2.5g、熱架橋性化 合物HML-TPHAP (商品名、本州化学工業 (株) 製) 1. 5gを溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成 物のワニスDを得た。得られたワニスを用いて前記のよ うに、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜 を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像 度、収縮率について評価を行った。

### 【0141】実施例5

実施例3で得られたポリマー溶液50gに実施例1で用 いたキノンジアジド化合物 (1) 2.5 g、熱架橋性化 合物ジメチロールーBisOC-P(商品名、本州化学 工業(株)製)2g、BisRS-2P(商品名、本州 化学工業(株)製)2gを溶解させて感光性ポリイミド 前駆体組成物のワニスEを得た。得られたワニスを用い て前記のように、シリコンウエハー上に感光性ポリイミ ド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜 率、解像度、収縮率について評価を行った。

## 【0142】実施例6

実施例1で得られたポリマー溶液40gに実施例2で用 いたキノンジアジド化合物(2)2g、熱架橋性化合物 DML-POP (商品名、本州化学工業 (株) 製) 2. 5g、TrisP-PA(商品名、本州化学工業(株) 製) 2. 5gを溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成 物のワニスFを得た。得られたワニスを用いて前記のよ うに、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜 を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像 度、収縮率について評価を行った。

## 【0143】実施例7

実施例4で得られたポリマー溶液40gに実施例2で用 いたキノンジアジド化合物 (2) 2g、熱架橋性化合物 DML-MTrisPC (商品名、本州化学工業 (株) 製) 2g、BIR-PC (商品名、旭有機材工業 (株) 製) 2.5 gを溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成 物のワニスGを得た。得られたワニスを用いて前記のよ うに、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜 を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像 度、収縮率について評価を行った。

## 【0144】実施例8

実施例4で得られたポリマー溶液40gに実施例2で用 いたキノンジアジド化合物(2)2g、熱架橋性化合物 2, 6-ジアセトキシメチル-p-クレゾール1.5

-20-

1.5gを溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成物の ワニスHを得た。得られたワニスを用いて前記のよう に、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜を 作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、 収縮率について評価を行った。

#### 【0145】実施例9

実施例3で得られた溶液30gに合成例7で得られたキ ノンジアジド化合物 (3) 1. 6g、熱架橋性化合物M L-26X(商品名、本州化学工業(株)製)2gを溶 解させて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニス I を得 10 た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウ エハー上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現 像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、収縮率について 評価を行った。

#### 【0146】実施例10

乾燥窒素気流下、4, 4'ージアミノジフェニルエーテ ル10.89g(0.054モル)、1,3-ビス(3 -アミノプロピル) テトラメチルジシロキサン1.86 g(0.007モル)、末端封止剤として、3-アミノ フェノール (東京化成工業 (株) 製) 2. 05g (0. 019モル)をN-メチル-2-ピロリドン (NMP) 20gに溶解させた。ここにビス(3,4-ジカルボキ シフェニル) エーテル二無水物23.27g(0.07 5モル)をNMP15gとともに加えて、20℃で1時 間反応させ、次いで50℃で4時間反応させた。その 後、N, N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール 15. 19g(0. 127モル)をNMP4gで希釈し た溶液を10分かけて滴下した。滴下後、50℃で3時 間攪拌した。続いてNMP46.0gを加え、これをポ リマー溶液を得た。

【0147】得られたポリマー溶液に上記に示したナフ トキノンジアジド化合物 (1) 7g、熱架橋性化合物と して"ニカラック"MX-270 (商品名、(株) 三和 ケミカル製)3.5g、フェノール性水酸基を有する化 合物としてBis-Z(商品名、本州化学工業(株) 製) 4gを加えて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニ ス」を得た。得られたワニスを用いて前記のように、シ リコンウエハ上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露 光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度について評 価を行った。

#### 【0148】実施例11.

乾燥窒素気流下、3,4'-ジアミノジフェニルエーテ ル10.14g (0.051モル)、1,3-ビス(3 ーアミノプロピル) テトラメチルジシロキサン1.86 g(0.075モル)、末端封止剤として、4-アミノ チオフェノール (東京化成工業 (株) 製) 4. 26g (0.034モル)、ピリジン11.93g (0.15 1モル)をN-メチル-2-ピロリドン (NMP) 50 gに溶解させた。ここに、2,2ーピス(3,4ージカ

ジエチルエステルジクロリド溶液 (a) 358.03 (0.076モル)を、系内が10℃以上にならないよ うに滴下した。滴下後、室温で6時間攪拌した。反応終 了後、溶液を水21に投入して、ポリマー固体の沈殿を ろ過で集めた。ポリマー固体を80℃の真空乾燥機で2 0時間乾燥した。

【0149】このようにして得たポリマー固体10gを 計り、上記に示したナフトキノンジアジド化合物 (2) 2.9g、熱架橋性化合物として、"ニカラック"MX -280 (商品名、(株) 三和ケミカル製) O.8g、 フェノール性水酸基を有する化合物としてBisRS-2P (商品名、本州化学工業 (株) 製) 1. 3g、ビニ ルトリメトキシシラン0.3gとをガンマブチロラクト ン23gに溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成物の ワニスKを得た。得られたワニスを用いて前記のよう に、シリコンウエハ上に感光性ポリイミド前駆体膜を作 製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度につ いて評価を行った。

#### 【0150】実施例12

乾燥窒素気流下、4,4'ージアミノジフェニルスルホ ン3. 97g (0. 016モル)、1, 3ーピス (3-アミノプロピル) テトラメチルジシロキサン1.39g (0.0056モル)、ピリジン6.16g (0.07 8モル) をN-メチル-2-ピロリドン (NMP) 50 gに溶解させ、室温で2時間反応した。ここに、3, 3', 4, 4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸ジエ チルエステルジクロリド溶液 (b) 113.66g (0.039モル)を、系内が10℃以上にならないよ うに滴下した。滴下後、室温で4時間攪拌した。つづい て、末端封止剤として、無水マレイン酸2. 72g (0.0278モル)を添加し、50℃で3時間攪拌反 応した。反応終了後、溶液を水21に投入して、ポリマ 一固体の沈殿をろ過で集めた。ポリマー固体を80℃の 真空乾燥機で20時間乾燥した。

【0151】このようにして得られたポリマーの固体1 0gに上記にしめしたナフトキノンジアジド化合物

(3) 2g、熱架橋性化合物としてTMOM-BP (商 品名、本州化学工業 (株) 製) O. 42g、TrisP -PA (商品名、本州化学工業 (株) 製) 1. 0 g を N 40 MP22gに溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成物 のワニスLを得た。得られたワニスを用いて前記のよう に、シリコンウエハ上に感光性ポリイミド前駆体膜を作 製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度につ いて評価を行った。

#### 実施例13

乾燥窒素気流下、合成例2で得られたヒドロキシル基含 有ジアミン(b) 2、13g(0.0035モル)、 4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル10.18g (0.0505モル)、1,3-ビス(3-アミノプロ ルポキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン二無水物の 50 ピル) テトラメチルジシロキサン1.86g(0.00

7モル)、末端封止剤として、3-アミノフェノール (東京化成工業 (株) 製) 2. 05g (0. 019モ ル)をN-メチルー2ーピロリドン(NMP)50gに 溶解させた。ここにビス(3,4-ジカルボキシフェニ ル) エーテル二無水物23.27g(0.0705モ ル) をNMP30gとともに加えて、20℃で1時間反 応させ、次いで50℃で4時間反応させた。その後、 N, N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール1 5. 19g (0. 127モル) をNMP10gで希釈し た溶液を10分かけて滴下した。滴下後、50℃で3時 10 合物として、2,6-ジアセトキシメチルーpークレゾ 間攪拌した。反応終了後、溶液を水21に投入して、ポ リマー固体の沈殿をろ過で集めた。ポリマー固体を80 ℃の真空乾燥機で20時間乾燥した。

【0152】このようにして得たポリマーの固体10g を計り、上記に示したナフトキノンジアジド化合物 (1) 2g、熱架橋性化合物として、"ニカラック" M

X-270 (商品名、 (株) 三和ケミカル製) 2.0 g、フェノール性水酸基を有する化合物としてBIR-PC (商品名、旭有機材工業 (株) 製) 1.5 g、ビニ ルトリメトキシシラン 0.3 gをGBL30 gに溶解さ 20 せて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスMを得た。 得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハ 上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、 ワニスの感度、残膜率、解像度について評価を行った。 【0153】実施例14

乾燥窒素気流下、合成例2で得られたヒドロキシル基含 有ジアミン (b) 29.58g (0.0486モル)、 3, 4'ージアミノジフェニルエーテル1.09g (0.0054モル)、1,3ービス(3ーアミノプロ ピル) テトラメチルジシロキサン1.86g (0.00 30 た。 7モル)、末端封止剤として、3-アミノフェノール (東京化成工業(株)製)2.05g(0.019モ ル)をN-メチル-2-ピロリドン (NMP) 50gに 溶解させた。ここにビス (3, 4-ジカルボキシフェニ ル) エーテル二無水物23.27g(0.0705モ ル)をNMP30gとともに加えて、20℃で1時間反 応させ、次いで50℃で4時間反応させた。その後、 N, N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール1 5. 19g (0. 127モル) をNMP10gで希釈し た溶液を10分かけて滴下した。滴下後、50℃で3時 40 間攪拌した。反応終了後、溶液を水21に投入して、ポ リマー固体の沈殿をろ過で集めた。ポリマー固体を80 ℃の真空乾燥機で20時間乾燥した。

【0154】このようにして得たポリマーの固体10g を計り、上記に示したナフトキノンジアジド化合物 (1) 2g、熱架橋性化合物として、2, 6-ジメトキ シメチルー4-t-プチルフェノール(商品名、本州化 学工業(株)製) 2. 0g、フェノール性水酸基を有す る化合物としてTrisP-PA(商品名、本州化学工 業(株)製)1.5g、ビニルトリメトキシシラン0.

3gとをGBL30gに溶解させて感光性ポリイミド前 駆体組成物のワニスNを得た。得られたワニスを用いて 前記のように、シリコンウエハ上に感光性ポリイミド前 駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、 解像度について評価を行った。

42

#### 【0155】実施例15

実施例2で得られたポリマー固体5gを計り、実施例1 1で得られたポリマー固体5gを計り、上記に示したナ フトキノンジアジド化合物(2) 2. 9g、熱架橋性化 ール2.0g、フェノール性水酸基を有する化合物とし て4PC(商品名、旭有機材工業(株)製)3.5g、 ビニルトリメトキシシラン0.3gとをガンマブチロラ クトン30gに溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成 物のワニスPを得た。得られたワニスを用いて前記のよ うに、シリコンウエハ上に感光性ポリイミド前駆体膜を 作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度に ついて評価を行った。

#### 【0156】実施例16

乾燥窒素気流下、2,2ービス(3-アミノー4-ヒド ロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン18.3g (0.05モル)をN-メチル-2-ピロリドン (NM P) 50g、グリシジルメチルエーテル26.4g (0.3モル) に溶解させ、溶液の温度を-15℃まで 冷却した。ここにジフェニルエーテルジカルボン酸ジク ロリド7. 38g (0. 025モル)、イソフタル酸ジ クロリド5. 08g (0. 025モル) をGBL25g に溶解させた溶液を内部の温度が0℃を越えないように 滴下した。滴下終了後、6時間、-15℃で攪拌を続け

【0157】反応終了後、溶液を水31に投入して白色 の沈殿を集めた。この沈殿をろ過で集めて、水で3回洗 浄した後、80℃の真空乾燥機で20時間乾燥した。 【0158】このようにして得られたポリマー粉体10

gにキノンジアジド化合物 (2) 2.0g、熱架橋性化 合物TM-BIP-A (商品名、旭有機材工業 (株) 製)1gをNMP30gに溶解させて感光性ポリベンゾ オキサゾール前駆体組成物のワニスQを得た。得られた ワニスを用いて前記のように、シリコンウエハー上に感 光性ポリベンゾオキサゾール前駆体膜を作製、露光、現 像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、収縮率について 評価を行った。

#### 【0159】実施例17

乾燥窒素気流下、合成例2で得られたヒドロキシル基含 有ジアミン(b) 15.1g(0.025モル)をN-メチルー2-ピロリドン (NMP) 50gに溶解させ た。ここに合成例1で得られたヒドロキシ基含有酸無水 物 (a) 17.5g (0.025モル) をピリジン30 gとともに加えて、60℃で6時間反応させた。反応終 50 了後、溶液を水21に投入して、ポリマー固体の沈殿を

ろ過で集めた。ポリマー固体を80℃の真空乾燥機で20時間乾燥した。

【0160】このようにして得たポリマーの固体10gを計り、合成例6で得られたキノンジアジド化合物

(2) 2g、熱架橋性化合物"ニカラック"MX-28 0(商品名、(株)三和ケミカル製)2g、Bis-Z (商品名、本州化学工業(株)製)1.5g、ビニルト リメトキシシラン1gとをGBL30gに溶解させて感 光性ポリイミド前駆体組成物のワニスRを得た。得られ たワニスを用いて前記のように、シリコンウエハー上に 感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニ スの感度、残膜率、解像度、収縮率について評価を行っ た。

#### 【0161】実施例18

厚さ1.1mmの無アルカリガラス表面にスパッタリング蒸着法によって厚さ130nmのITO透明電極膜が形成されたガラス基板を120×100mmの大きさに切断した。ITO基板上にフォトレジストを塗布して、通常のフォトリソグラフィ法による露光・現像によってパターニングした。ITOの不要部分をエッチングして 20 除去した後、フォトレジストを除去することで、ITO 膜をストライプ形状にパターニングした。このストライプ状第一電極は100μmピッチである。

【0162】次に、実施例1で得られたワニスAの濃度 調整をNMPを用いて行い、スピンコート法により第一 電極を形成した基板上に塗布し、ホットプレート上で1 20℃で3分間プリベークした。この膜にフォトマスク を介してUV露光した後、2.38%TMAH水溶液で 露光部分のみを溶解させることで現像し、純水でリンス した。得られたポリイミド前駆体パターンをクリーンオ 30 一ブン中の窒素雰囲下で170℃、30分、さらに、3 20℃で60分加熱してキュアし、絶縁層を第一電極の エッジを覆うように形成した。絶縁層の厚さは約1μm であった。

【0163】次に、絶縁層を形成した基板を用いて有機 電界発光装置の作製を行った。発光層を含む薄膜層は、 抵抗線加熱方式による真空蒸着法によって形成した。基 板有効エリア全面に蒸着して正孔輸送層を形成し、シャ ドーマスクを用いて発光層、第二電極のアルミニウムを 形成した。

【0164】得られた上記基板を蒸着機から取り出し、 基板と封止用ガラス板とを硬化性エポキシ樹脂を用いて 貼り合わせることで封止した。このようにしてITOストライプ状第一電極上に、パターニングされた発光層が 形成され、第一電極と直交するようにストライプ状第二 電極が配置された単純マトリクス型カラー有機電界発光 装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、 良好な表示特性を得ることができた。絶縁層の境界部分 で薄膜層や第二電極が、薄くなったり段切れを起こすよ うなこともなく、スムーズに成膜されたので、発光領域 50 内での輝度ムラは認められず、安定な発光が得られた。 まだ断面は順テーパーになっていた。

【0165】実施例19

実施例2で得られたワニスBを用い、キュア条件を230℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。

【0166】実施例20

9 実施例5で得られたワニスEを用い、キュア条件を23 0℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単 純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本 表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められ ず良好な表示特性を得ることができた。

#### 【0167】実施例21

実施例8で得られたワニスHを用い、キュア条件を250℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。

【0168】実施例22

実施例17で得られたワニスRを用い、キュア条件を230℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。

【0169】実施例23

実施例10で得られたワニス」を用い、キュア条件を250℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、 単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。 本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。

【0170】実施例24

実施例13で得られたワニスMを用い、キュア条件を230℃で60分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラも認められず良好な表示特性を得ることができた。

【0171】実施例25

キュア条件をオーブンの空気雰囲気で230℃で30分加熱、絶縁層の厚さを3μmにした以外は実施例18と同様の方法で、第一電極を形成した基板上に感光性ポリイミドからなる絶縁層を形成した。体積抵抗率は少なくとも5×10<sup>10</sup>Ωcmあることを確認した。絶縁層の境界部分の断面は、順テーパー形状であり、テーパー角度は約45°であった。また、絶縁層の赤外吸収スペクトルを反射配置で測定したところ、1780cm<sup>-1</sup>付近、1377cm<sup>-1</sup>付近にポリイミドに起因するイミド構造の吸収ピークが検出された。

【0172】次に、絶縁層を形成した基板を用いて有機

電界発光装置の作製を行った。絶縁層を形成したガラス 基板上に、酸素プラズマまたはUV照射処理をした。そ の後、アルコールに溶解した正孔注入材料または正孔輸 送材料を、基板上にスピンコートして製膜した。オーブ ンを用いて、200℃で30分の加熱を行った。

【0173】さらに、インクジェット法を用いて、トル エンに溶解した有機発光材料(赤色、青色、緑色の各材 料)を各開口部にパターン塗布した。オーブンを用い て、80℃で30分の加熱を行った。最後に、実施例1 8と同様の方法で、第二電極を形成し、封止を行った。 【0174】このようにして幅 $80\mu m$ 、ピッチ100μm、本数816本のITOストライプ状第一電極上 に、パターニングされた緑色発光層、赤色発光層および 青色発光層が形成され、第一電極と直交するように幅2 50μm、ピッチ300μmのストライプ状第二電極が 200本配置された単純マトリクス型カラー有機電界発 光装置を作製した。赤、緑、青の3つの発光領域が1画 素を形成するので、本発光装置は300μmピッチで2 72×200画素を有する。絶縁層が第一電極を露出せ しめる部分のみが発光するので、1つの発光領域は幅7 0 μm、長さ250 μmの長方形である。

【0175】本表示装置を線順次駆動したところ、良好な表示特性を得ることができた。第一電極のエッジ部分が絶縁層で覆われているために、電界集中による短絡は認められなかった。また、断面が順テーパー形状であることから、絶縁層の境界部分で薄膜層や第二電極が、薄くなったり段切れを起こすようなこともなく、スムーズに成膜されたので、発光領域内での輝度ムラは認められず、安定な発光が得られた。また、耐久性試験として、85℃で250時間保持した後の発光特性を評価したと 30ころ、初期と比べて発光領域が小さくなることなく良好な発光を示した。

#### 【0176】実施例26

2電極を形成し、封止を行った。

スイッチング素子を有する基板 (TFT基板) の平坦化 膜上に、平坦化膜上にあるソース・ドレイン電極に接触 した、所望のパターンのITO電極 (画素) を設けた。 【0177】本基板を用いて、実施例25と同様に、絶 縁層、正孔注入材料または正孔輸送材料、発光材料、第

【0178】本表示装置をアクティブマトリックス方式 40 で駆動したところ、良好な表示特性を得ることができた。第一電極のエッジ部分が絶縁層で覆われているために、電界集中による短絡は認められなかった。また、断面が順テーパー形状であることから、絶縁層の境界部分で薄膜層や第二電極が、薄くなったり段切れを起こすようなこともなく、スムーズに成膜されたので、発光領域内での輝度ムラは認められず、安定な発光が得られた。また、耐久性試験として、85℃で250時間保持した後の発光特性を評価したところ、初期と比べて発光領域が小さくなることなく良好な発光を示した。 50

#### 【0179】比較例1

実施例1と同様に合成したポリイミド前駆体溶液40gに実施例1で用いたキノンジアジド化合物(1)2.0gを溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスA1を得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、収縮率について評価を行った。

#### 【0180】比較例2

10 実施例1と同様に合成したポリイミド前駆体溶液40gに実施例1で用いたキノンジアジド化合物(1)2g、TrisP-PA(商品名、本州化学工業(株)製)1gを溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスA2を得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、収縮率について評価を行った。

#### 【0181】比較例3

実施例3と同様に合成したポリイミド前駆体溶液30gに実施例3で用いたキノンジアジド化合物(3)1.6g、BisP-AP(商品名、本州化学工業(株)製)0.8gを溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスA3を得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、収縮率について評価を行った。

## 【0182】比較例4

実施例4で得られたポリマー溶液40gに実施例2で用いたキノンジアジド化合物(2)2g、本発明とは異なる熱架橋性化合物メラミン1.0g、BIR-PC(商品名、旭有機材工業(株)製)1.0gを溶解させて感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスA4を得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハー上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度、収縮率について評価を行った。

#### 【0183】比較例5

実施例10の熱架橋性化合物を用いない他は、実施例10と同様に行い、感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスA5を得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハ上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度について評価を行った。

## 【0184】比較例6

実施例13の熱架橋性化合物を用いない他は、実施例13と同様に行い、感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスA6を得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハ上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、ワニスの感度、残膜率、解像度について50評価を行った。

#### 【0185】比較例7

実施例15の熱架橋性化合物を用いない他は、実施例15と同様に行い、感光性ポリイミド前駆体組成物のワニスA7を得た。得られたワニスを用いて前記のように、シリコンウエハ上に感光性ポリイミド前駆体膜を作製、露光、現像し、

#### 比較例8

比較例1で得られたワニスA1を用いて、キュア条件を300℃で60分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製し 10た。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラは認められなかったが、発光表示部のエッジ部に発光ムラが多数認められ、良好な表示特性を得ることができなかった。

#### 【0186】比較例9

比較例2で得られたワニスA2を用いて、キュア条件を230℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラは認められなかったが、発光表示部のエッジ部に発光ムラが20多数認められ、良好な表示特性を得ることができなかった。

#### 【0187】比較例10

比較例4で得られたワニスA4を用いて、キュア条件を250℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラは認められなかったが、発光表示部のエッジ部に発光ムラが多数認められ、良好な表示特性を得ることができなかった。

#### 【0188】比較例11

比較例5で得られたワニスA5を用いて、キュア条件を250℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラは認められなかったが、発光表示部のエッジ部に発光ムラが多数認められ、良好な表示特性を得ることができなかった。

## 【0189】比較例12

比較例6で得られたワニスA6を用いて、キュア条件を230℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラは認められなかったが、発光表示部のエッジ部に発光ムラが多数認められ、良好な表示特性を得ることができなかっ

## 【0190】比較例13

比較例7で得られたワニスA7を用いて、キュア条件を230℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラは認められなかったが、発光表示部のエッジ部に発光ムラが多数認められ、良好な表示特性を得ることができなかった。

#### 【0191】比較例14

実施例1と同様に合成したポリイミド前駆体溶液40gに実施例1で用いたキノンジアジド化合物(1)2.0g、オニウム塩であるDPI-TF(商品名、東洋合成工業(株)社製)0.5gを溶解させて得られたワニスA8を用いて、キュア条件を250℃で30分にした他は、実施例18と同様にして、単純マトリクス型カラー有機電界発光装置を作製した。本表示装置を線順次駆動したところ、輝度ムラが認められかつ、発光表示部のエッジ部に発光ムラが多数認められ、良好な表示特性を得ることができなかった。

[0192]

【化33】

30

#### **DPI-TF**

【0193】実施例1~17、比較例1~7の評価結果 については以下の表1に示した。

[0194]

【表1】

表 1	49			30				
	熱架橋性化合物	ポリマーの末 端基	フェノール性 低分子化合物	ワニス	感度 (msec)	残膜率 (%)	解像度 (µm)	収縮率 (%)
実施例 1	ニカラックMXー270	無し	無し	A	900	9.0	1.0	2 7
実施例 2	DML-MBPC	無し	Bis-Z	В	950	90	10	2.5
実施例 3	TML-HQ	無し	無し	С	850	8.9	10	24
実施例 4	HML-TPHAP	無し	無し	D	1000	90	10	23
実施例 5	ジプチロールーBisOC-P	無し	BisRS-2P	Ε	950	8.9	10	28
実施例 6	DML-POP	無し	TrisP-PA	F	950	91	10	28
	DML-MTrisPC	無し	BIR-PC	Ġ	1000	90	10	28
	2,6ージ アセトキシメチルーpークレゾ ール	無し	BIR-PC	н	1000	87	10	23
	ML-25X	無し	無し	i	950	87	10	3 3
	ニカラックMX-270	3-7ミノフェノール	Bis-Z	J	950	90	10	2 4
実施例 1.1	ニカラックMX-280	4-7ミノチオフェノール	Bis-Z	ĸ	850	89	10	2 5
	TMON-BP	無水マレイン酸	TrisP-PA	L	850	8 9	10	23
実施例 1 3	ニカラックMX-270	3-7ミノフェノール	BIR-PC	M	800	90	10	2 4
実施例 1 4	2.6ージ メトキシメチルー4ーtーブ チルフェノー	3-7ミノフェノール	TrisP-PA	N	650	88	10	25
実施例 1 5	2,6ージ アセトキシメチルーロークレゾ ール	4-7ミノチオフェノール	4PC	P	750	88	10	23
実施例 1 6	TM-BIP-A	無し	無し	Q	1050	87	10	25
実施例17	ニ <u>カラックMX</u> ー280	無し	Bis-Z	R	750	87	10	25
	無し	無し	無し	A 1	1800	8 5	30	38
比較例2	無し	無し	TrisP-PA	A 2	1600	8 5	20	40
	無し	無し	BisP-AP	A 3	1550	8 4	20	40
	メラミン	無し	BIR-PC	A 4	1500	8 4	20	33
	無し	3-7ミノフェノール	Bis-Z	A 5	1400	8 4	20	4 0
比較例 6	無し	3ーアミノフェノール	BIR-PC	A 6	1400	8 4	20	40
比較例7	無し	4-7ミノチオフェノール	4PC	A 7	1400	8 4	20	40

## [0195]

【発明の効果】本発明によれば、アルカリ水溶液で現像でき、解像度、感度に優れ、なかでも未露光部の膜減りが小さく(残膜率が小さく)、さらにキュア後の収縮率

が小さいという優れたポジ型の感光性樹脂前駆体組成物 を得ることができ、得られた組成物は特に、半導体素子 の保護膜、層間絶縁膜、ディスプレイの絶縁層に好適に 用いることができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

HO1L 21/312

HO1L 21/30

502R

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AB16 AC01 AD03 BEO1 CB25 CB26 CB45 CB52 CC20 FA03 FA17 FA29 4J043 PA04 PA19 PB03 PB04 PB23 PB24 PC025 PC065 PC145 PC205 QB15 QB26 QB32 RA06 SA05 SA06 SA54 SA62 SA71 SA82 SA83 SB01 SB02 TA02 TA12 TA14 TA21 TA22 TA32 TA72 TA75 TA76 UA032 UA041 UA042 UA121 UA122 UA131 UA132 UA141 UA151 UA261 UA361 UA381 UA762 UB011 UB012 UB021 UB022 UB061 UB062 UB122 UB131 UB141 UB152 UB221 UB231 UB232 UB301 UB302 UB401 UB402 VA011 VA012 VA021

> ZA21 ZA51 ZB22 5F058 AA10 AC02 AF04 AG01 AH02 AH03

VA022 VA051 VA052 VA061 VA062 VA071 VA081 VA082 XB06 XB07 XB09 ZA02 ZA12